

Εθνικό Μετσοβίο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολογών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Επικοινώνιων, Ηλεκτρονικής & Συστηματών Πληροφορικής

Μιογοαφική Διασκόπηση Γεωλογικών Δομών: Οογανολογία & Μετοήσεις Πεδίου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σεραφείμ Γ. Ζορμπάς

Επιβλέπων: Ευάγγελος Β. Χριστοφόρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Μάρτιος 2022



Εθνικό Μετσοβίο Πολύτεχνειο Σχολή Ηλεκτρολογών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Επικοινώνιων, Ηλεκτρονικής & Συστηματών Πληροφορικής

Μιογραφική Διασκόπηση Γεωλογικών Δομών: Οργανολογία & Μετρήσεις Πεδίου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σεραφείμ Γ. Ζορμπάς

Επιβλέπων: Ευάγγελος Β. Χριστοφόρου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 10ⁿ Μάρτη 2022.

Ευάγγελος Χοιστοφόρου	Κωνσταντίνος Αθανασάς	Παναγιώτης Τσαραμπάρης	
Καθηγητής Ε.Μ.Π.	Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.	Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.	
Καθηγητής Ε.Μ.Π.	Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.	Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.	

Αθήνα, Μάρτιος 2022

.....

Σεραφείμ Γ. Ζορμπάς

Διπλωματούχος Ηλεκτοολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Ζορμπάς Σεραφείμ, 2022.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγοφεύεται η αντιγφαφή, αποθήκευση και διανομή της παφούσας εφγασίας, εξ ολοκλήφου ή τμήματος αυτής, για εμποφικό σκοπό. Επιτφέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κεφδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή εφευνητικής φύσης, υπό την πφοϋπόθεση να αναφέφεται η πηγή πφοέλευσης και να διατηφείται το παφόν μήνυμα. Εφωτήματα που αφοφούν τη χφήση της εφγασίας για κεφδοσκοπικό σκοπό πφέπει να απευθύνονται πφος τον συγγφαφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεφάσματα που πεφιέχονται σε αυτό το έγγφαφο εκφφάζουν τον συγγφαφέα και δεν πφέπει να εφμηνευθεί ότι αντιπφοσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Από τη μέφα που ο Βίκτωφ Χες ανακάλυψε ότι οι κοσμικές ακτίνες πφοέφχονται από τον ουφανό και όχι το έδαφος με το διάσημο πείφαμά του με το αεφόστατο [1], ο κόσμος της σωματιδιακής φυσικής άλλαξε για πάντα. Ωστόσο, αν και ονομάζονται ακτίνες δεν είναι ακφιβώς, ακτίνες είναι κυφίως σωματίδια μεφικά πφοεφχόμενα από τον ήλιο, ενώ άλλα με υψηλότεφες ενέφγειες πφοέφχονται από αστέφια που εκφηγνύονται, μαύφες τφύπες και σουπεφνόβα. Η πφοέλευση αυτών των σωματιδίων είναι δύσκολο να πφοσδιοφιστεί μιας και όντας φοφτισμένα σωματίδια συνεχώς παφεκκλίνουν της ποφείας τους στο διάστημα. Οι κύφιες κοσμικές ακτίνες δεν καταφέφνουν να φτάσουν στην επιφάνεια της Γης μιας και συγκφούονται με μόφια της ατμόσφαιφας και διασπώνται σε επιμέφους σωματίδια 25 km πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Από αυτή τη διάσπαση πφοκύπτουν πιόνια, πρωτόνια μιόνια, ηλεκτφόνια, ποζιτφόνια και φωτόνια.

Με την παφούσα διπλωματική εφγασία στοχεύουμε να εντοπίσουμε αυτά τα σωματίδια και να τα μετφήσουμε τόσο σε πλήθος όσο και σε ένταση. Ακολουθούμε τη βιβλιογφαφία του *CosmicWatch* [37], ενός ανοιχτού λογισμικού πφότζεκτ απ' το MIT και παφάγουμε έναν επιτφαπέζιο ανιχνευτή κοσμικής ακτινοβολίας, μιας συσκευής με μικφές ενεφγειακές απαιτήσεις, που μεταφέφεται εύκολα και σχετικά φθηνή. Αφού αναλύσουμε τα στάδια παφαγωγής, χφησιμοποιούμε το όφγανο για μεφικές ενδεικτικές μετφήσεις όπου επιβεβαιώνουμε τη θεωφία σχετικά με την αλληλεπίδφαση της ακτινοβολίας με την ύλη. Μελλοντικές εφαφμογές ανίχνευσης μιονίων μποφεί να είναι η φαδιογφαφική διασκόπηση γεωλογικών δομών και όχι μόνο. Αυτή η μέθοδος έχει ονομαστεί και "Μιογφαφία".

Λέξεις κλειδιά: μιογραφία, αισθητήρας, κοσμικές ακτίνες, ανίχνευση μιονίων

Abstract

Since the day Victor Hess discovered that cosmic rays come from the sky and not from the ground with his famous balloon experiment [1], the world was fascinated and a whole new world of possibilities was opened. Although those aren't exactly rays, they are particles. Some of them are from the sun, but they have comparatively low energy. High energy cosmic rays moving very close to the speed of light come from exploding stars, supernovae in our own galaxy and in others and the highest energy particles are thought to come from black holes, but it's hard to tell where exactly they come from because as charged particles they are deflected by magnetic fields in space. But primary cosmic rays don't make it down to earth's surface, instead they collide with air molecules around 25km above the ground and create new particles like pions, then those collide and create other particles like protons, muons, electrons, positrons and photons.

With this dissertation we aim to detect those particles, specifically muons. We follow the documentation of *CosmicWatch* [37], an open-source project developed from MIT, and we develop a desktop muon detector, a low power, portable and relatively cheap device. After developing it we use it on a few applications aiming to cross check the physics behind it. Future applications of muon detection can include the use of a radiographic technique to image a subsurface using cosmic-ray muons also known as muography.

keywords: muography, sensors, cosmic rays, arduino, muon detection, particles

Ευχαριστίες

Η παφούσα διπλωματική εφγασία εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 στη Σχολή Ηλεκτφολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεφγασία με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουφγών.

Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κωνσταντίνο Αθανασά, για την εμπιστοσύνη του, την αμέριστη βοήθεια και τη καθοδήγηση που μου προσέφερε από τη πρώτη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Ευάγγελο Χριστοφόρου, ο ενθουσιασμός του για το αντικείμενο και για την μετάδοση της γνώσης σε συνδυασμό με την ακατάπαυστη ερευνητική του συνεισφορά υπήρξε για μένα η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης και ο βασικότερος παράγοντας που με οδήγησε να ασχοληθώ με το αντικείμενο των αισθητήρων. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Σπύρο Αγγελόπουλο για τις πολύτιμες γνώσεις του και τη βοήθειά του από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπόνησης αυτής της εργασίας και τα μέλη του Libre Space Foundation οι οποίοι με την εμπειρία και τις άψογες συμβουλές τους με βοήθησαν να ολοκληρώσω επιτυχώς την εργασία.

Μέσα από τη καφδιά μου θέλω να ευχαφιστήσω τους γονείς μου, Γιώφγο και Ελένη και τα αδέφφια μου Πφοκόπη, Άγγελο και Κωνσταντίνο για την στήφιξη και αστείφευτη αγάπη που μου παφείχαν τόσα χφόνια. Ήταν και είναι πάντα δίπλα μου και χωφίς αυτούς δεν θα είχα καταφέφει τίποτα.

Στους φίλους μου, Βασίλη, Ιορδάνη, Νίκο, Γιώργο, Στέλιο, Παναγιώτη, Κώστα, Θανάση Χριστιάνα και Βιολέτα για τα καταπληκτικά μας χρόνια και τις αξέχαστες εμπειρίες που ζήσαμε μαζί. Δε θα μπορούσα να φανταστώ αυτά τα χρόνια χωρίς αυτούς. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, Γεωργία Γκιόκα, για τον θαυμασμό της, την στήριξη και τη πίστη της σε μένα όλα αυτά τα χρόνια, με έχει βοηθήσει στο να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα.

Περιεχόμενα

Πεϱίληψη	v
Abstract	vi
Ευχαοιστίες	vii
Πεοιεχόμενα	viii
Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή	1
1.1 Στόχος	1
1.2 Δομή	2
Κεφάλαιο 2 - Θεωوητικό Υπόβαθοο	4
2.1 Πηγές Ιονίζουσας Ακτινοβολίας	4
2.1.1 Κοσμική Ακτινοβολία	4
2.1.2 Διακυμάνσεις στη φοή Μιονίων	9
2.2 Αλληλεπίδοαση ακτινοβολίας με την ύλη	11
2.2.1 Βαρέα φορτισμένα σωματίδια	12
2.2.2 Ταχέα ηλεκτρόνια	12
2.2.3 Φωτόνια	13
2.2.4 Νετρόνια	14
2.2.5 Καταιγισμοί	15
Κεφάλαιο 3 - State of the art	16
3.1 Ανιχνευτές Ακτινοβολιών	16
3.1.1 Απαριθμητής Geiger	17
3.1.2 Ανιχνευτής με δίοδο ημιαγωγού	18
3.1.3 Σπινθηριστές	18
3.1.4 Φωτογραφικό Γαλάκτωμα	20
3.1.5 Θάλαμος Νέφους	20
3.1.6 Θάλαμος Σπινθήρων	21
3.2 Ανιχνευτές Μεμονωμένων Φωτονίων	21
3.2.1 Φωτοπολλαπλασιαστής σε σωλήνα (Photomultiplier Tube ή PMT)	22
3.2.2 PIN Diodes & Avalanche Photodiodes (APD's)	23
3.2.3 Φωτοπολλαπλασιαστής Πυριτίου (Silicon Photomultiplier ή SiPM)	24

3.2.3.1 The Geiger Mode in Silicon	26
3.2.3.2 Φωτοπολλοπλασιαστής Πυριτίου	27
3.2.4 Επίδοση και Τεχνικά χαρακτηριστικά	29
3.2.4.1 Breakdown Voltage & Over-Voltage	29
3.2.4.2 Κέφδος	30
3.2.4.3 Αποδοτικότητα Ανίχνευσης Φωτονίων (ΑΑΦ - Photo Detection Efficiency)	31
3.2.4.4 Θόουβος	33
3.2.4.5 Οπτική διεπαφή	34
3.2.4.6 Δυναμικό Εύφος και Γφαμμικότητα	35
3.2.4.7 Σχήμα Παλμού	36
3.2.4.8 Θεομική Εξάοτηση	38
Κεφάλαιο 4 - Κατασκευή οργάνου	40
4.1 Συνοπτικά Βήματα κατασκευής	41
4.2 Αναλυτικά Βήματα κατασκευής	42
4.2.1 Αγοράζοντας τα υλικά	42
4.2.2 Εισαγωγή του κώδικα στο Arduino	45
4.2.3 Κατασκευάζοντας την πλακέτα	47
4.2.3.1 Η Κεντρική Πλακέτα	48
4.2.3.2 Πλακέτα του SiPM	50
4.2.3.3 Πλακέτα της κάφτας microSD	51
4.2.4 Προσαρμογή του πλαστικού σπινθηριστή	52
4.2.5 Συνδέοντας τον πλαστικό σπινθηριστή με την πλακέτα του SiPM	54
4.2.6 Τελική συναρμολόγηση όλων των στοιχείων	55
Κεφάλαιο 5 - Ηλεκτوονική Λειτουργία	59
5.1 Περιγραφή Κυκλώματος	60
5.1.1 DC-DC Booster	60
5.1.2 Κύκλωμα SiPM	62
5.1.3 Ενίσχυση του σήματος & Ανιχνευτής Peak Detector	64
5.1.4 microSD card & κύκλωμα	66
5.1.5 Arduino Nano	66
5.2 Καταγραφή των δεδομένων	69
5.2.1 Οθόνη OLED	69

5.2.2 Arduino Serial Monitor	70
5.2.3 Καταγραφή στον υπολογιστή μέσω Python script	70
5.2.4 Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο μέσω ιστότοπου	71
5.2.5 microSD	72
5.2.6 Μορφή των δεδομένων	72
5.3 Αντιμετώπιση Προβλημάτων	73
Κεφάλαιο 6 - Μετρήσεις & Συμπεράσματα	75
6.1 Μετρήσεις Πεδίου	76
6.1.1 Μέτρηση #01 & Βαθμονόμηση	76
6.1.2 Μέτρηση #02 & Χρήση ιστοσελίδας για ζωντανή προβολή	78
6.1.3 Μέτρηση #03 - Περιοχή κέντρου Αθηνών	81
6.2 Μελλοντικές Μετρήσεις	84
6.3 Βελτιώσεις & ποοτάσεις για το μέλλον	85
Βιβλιογραφία	88
Παράρτημα	94
Ευρετήριο Σχημάτων & Πινάκων	106

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Στόχος

Στόχος της παφούσας διπλωματικής εφγασίας, είναι ο εντοπισμός κοσμικής ακτινοβολίας και το πώς αλληλεπιδφά με την ύλη, συγκεκφιμένα με γεωλογικές δομές. Ο εντοπισμός της ακτινοβολίας γίνεται με τη χφήση ενός επιτφαπέζιου ανιχνευτή μιονίων ο οποίος κατασκευάστηκε, βαθμονομήθηκε και χφησιμοποιήθηκε στο πεδίο. Η πλειοψηφία των ανιχνευτών που χφησιμοποιούνται για εφευνητικούς σκοπούς έχουν μεγάλες ενεφγειακές απαιτήσεις, οι σπινθηφιστές που χφησιμοποιούνται είναι ιδιαίτεφα ακφιβοί και δεν είναι καθόλου εύκολοι στη μεταφοφά.

Επομένως, για τη παφούσα διπλωματική μελέτη επιλέξαμε μια κατασκευή με σχετικά χαμηλό κόστος, εύκολη στη μεταφοφά για να χφησιμοποιηθεί στο πεδίο και με επαφκή βιβλιογφαφία από πίσω. Η συγκεκφιμένη κατασκευή έχει δοκιμαστεί από αφκετά ιδφύματα σε όλο το κόσμο και έχει χφησιμοποιηθεί σε πληθώφα εφαφμογών όπως νανο-δοφυφόφους, πυφηνικούς σταθμούς και εφαστήφια πανεπιστημίων και σχολείων.

Νέες τεχνολογικές ποοεκτάσεις της μελέτης μιονίων έχουν εφαομογές στο πεδίο της τηλεπισκόπησης, δηλαδή τη μελέτη και παρατήρηση των χαρακτηριστικών της γήινης επιφάνειας από απόσταση, βάσει της αλληλεπίδρασης των υλικών που βρίσκονται πάνω σε αυτή. Τα επιτεύγματα της τηλεπισκόπησης τα αξιοποιούμε καθημερινά, όπως στη μελέτη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων για τη πρόγνωση του καιρού, χαρτογράφηση του πλανήτη μας, μελέτη θερμοκρασίας, παρατήρηση του κλίματος κ.α. Με αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθεί αρκετά η "Μιογραφία" δηλαδή η ραδιογραφία με τη χρήση μιονίων. Η μιογραφία έχει εφαρμογές στη μελέτη αρχαίων μνημείων, πάχους στρωμάτων πάγου μέχρι και μελέτη πυκνότητας λάβας σε ηφαίστεια.

Το όφγανο που κατασκευάζουμε στη παφούσα διπλωματική εφγασία μποφεί να χφησιμοποιηθεί σε μια πφοκαταφκτική μελέτη γεωλογικών δομών, χωφίς όμως να μποφούμε να καταλήξουμε στην αποτύπωση κάποιας εικόνας μιας και η έξοδος που παίφνουμε από τον μετφητή είναι φυθμός καταγφαφής γεγονότων και όχι κάποιο δισδιάστατο φάσμα.

1.2 Δομή

Η εν λόγω διπλωματική μελέτη χωρίζεται σε 5 μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στις πηγές ιονίζουσας ακτινοβολίας και πως αλληλεπιδρά με την ύλη. Στη συνέχεια αναλύουμε τις μεθόδους ανίχνευσής της από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι τις συσκευές που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες και τα εφευνητικά κέντφα σήμεφα (State of the art) και καταλήγουμε στον αισθητήφα που χφησιμοποιούμε στη παφούσα κατασκευή.

Έπειτα περιγράφουμε τα βήματα κατασκευής του οργάνου, από τη παραλαβή των υλικών, τη συναρμολόγηση, το πακετάρισμα και τέλος τη βαθμονόμηση του. Αναλύεται η δοκιμή των επιμέρους υποσυστημάτων στο εργαστήριο, η σχεδίαση και ο προγραμματισμός του τελικού ενσωματωμένου συστήματος και ο τρόπος επικοινωνίας με τον υπολογιστή και η αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Τέλος παφουσιάζονται οι πειφαματικές μετφήσεις που πφαγματοποιήθηκαν και τα συμπεφάσματα που πφοέκυψαν από τις μετφήσεις, εντυπώσεις για το συνολικό πφοτεινόμενο σύστημα, καθώς και πφοτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις. Έπειτα ακολουθεί η βιβλιογφαφία και μετά το παφάφτημα, όπου βφίσκονται συγκεντφωμένα τα σχέδια CAD, το κύκλωμα και οι πίνακες με τα δεδομένα που χφησιμοποιήθηκαν σε όλα τα στάδια της εφγασίας.

3

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Πηγές Ιονίζουσας Ακτινοβολίας

2.1.1 Κοσμική Ακτινοβολία

Η Γη συνεχώς βομβαρδίζεται από ροή σωματιδίων, που ονομάζεται κοσμική ακτινοβολία. Το 74% της μάζας αυτής της ροής προέρχεται από ιονισμένο υδρογόνο, 18% από πυρήνες ηλίου (2 πρωτόνια και 2 νετρόνια) και το υπόλοιπο 8% αποτελείται από απομεινάρια βαρέων στοιχείων.

Τον Οκτώβοη του 1991, εντοπίστηκε κοσμική ακτίνα με ενέργεια, που υπολογίστηκε στα $3x10^{20}$ eV = 48 Joules η οποία είναι ανάλογη μιας μπάλας μπέιζμπολ να ταξιδεύει 100 km/h, και όλη αυτή η ενέργεια ήταν συσσωρευμένη μέσα σε ένα πρωτόνιο. Γι'αυτό και πήρε την ονομασία: '*Oh-My-God Particle*' [2].

Το μεγαλύτεοο μέρος της κοσμικής ακτινοβολίας που παρατηρείται στη Γη είναι σχετικιστική, που σημαίνει ότι, οι μεμονωμένοι πυρήνες έχουν κινητικές ενέργειες μεγαλύτερες από τη μάζα ηρεμίας τους ($E_k/mc^2 > 1$). Οι κοσμικές ακτίνες χαμηλότερης ενέργειας, τάξης μεγέθους των GeV, επηρεάζονται από ηλιακούς ανέμους και από το γεωμαγνητικό πεδίο, γεγονότα που μειώνουν σημαντικά την αλληλεπίδρασή τους με τη Γη. Η ακτινοβολια υψηλότερης ενέργειας εκτείνεται στα 10¹¹ GeV, που σε αυτά τα επίπεδα μια κοσμική ακτίνα μπορεί να χάσει ενέργεια από τις αλληλεπιδράσεις με τη Κοσμική Ακτινοβολία Μικροκυμάτων Υποβάθρου (*Cosmic Microwave Background - CMB/CMBR/CBR/MBR*).



Σχήμα **2.1** *The Cosmic Microwave Background as seen from the Planck satellite. Credit: (ESA - Planck CMB,* n.d.) [3]

Όταν μια κοσμική ακτίνα συγκρουστεί με έναν πυρήνα στα υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, συνήθως θα είναι ένας πυρήνας οξυγόνου ή μόριο αζώτου, η ενέργεια μπορεί να είναι τόσο μεγάλη, που μπορει να διασπάσει το πρωτεύον σωματίδιο ή το σωματίδιο με το οποίο συγκρούστηκε μέσω πυρηνικής αλληλεπίδρασης. Μεγάλο ποσοστό της ενέργειας της σύγκρουσης πάει στη παραγωγή σωματιδίων βραχείας ζωής, γνωστά ως μεσόνια [4].

Τα πιο κοινά μεσόνια είναι τα Π-μεσόνια ή πιόνια (π^+ , π^- , π^0) και μετά τα K-μεσόνια (K⁺, K⁻, K⁰). Τα φορτισμένα πιόνια (π±) διασπώνται σε περίπου 10 ns του δευτερολέπτου και παράγουν μιόνια και νετρίνα ίδιου φορτίου. Τα ουδέτερα μεσόνια (π⁰, K⁰) διασπώνται περίπου 1 δισεκατομμύριο φορές ταχύτερα (10⁻¹⁷s) απ'ότι τα φορτισμένα μεσόνια. Σε αντίθεση με τα ουδέτερα μεσόνια, τα φορτισμένα μεσόνια μπορούν να ταξιδέψουν πιο μακριά πριν διασπαστούν και έτσι να αλληλεπιδράσουν με άλλα σωματίδια που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα [5]. Αυτή η αλληλεπίδραση, μπορεί να έχει τη μορφή μιας επιπλέον πυρηνικής αλληλεπίδρασης αρκετά παρόμοιας με την αρχική αλληλεπίδραση της κοσμικής ακτίνας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί στη συνέχεια παράγοντας επιπλέον μεσόνια με αποτέλεσμα, έναν καταιγισμό από σωματίδια τα οποία προκλήθηκαν από μια κοσμική ακτίνα. Οι πρώτες κοσμικές ακτίνες δεν μπορούν να διεισδύσουν στον πλανήτη μας, λόγω της αόρατης ασπίδας της ατμόσφαιρας που μας περιβάλλει. Ωστόσο μια μικρή ροή πυρηνικών σωματιδίων (πρωτόνια ή νετρόνια) ενδέχεται να περάσουν και να φτάσουν στην επιφάνεια της Γης. Οι αλληλεπιδράσεις των κάθετα εισερχομένων κοσμικών ακτίνων λαμβάνουν μέρος σε υψόμετρο ~15 km, ενώ κοσμικές ακτίνες που εισέρχονται υπό γωνία θα αλληλεπιδράσουν σε μεγαλύτερα υψόμετρα μιας και στη πορεία τους θα συναντήσουν μεγαλύτερο όγκο ατμόσφαιρας.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται αναλυτικά το πως αλληλεπιδρά μια κοσμική ακτίνα με τα σωματίδια και πως καταλήγει να δημιουργηθεί ο καταιγισμός σωματιδίων, γνωστός ως *Cosmic Shower*.



Σχήμα 2.2 Καταιγισμός σωματιδίων και τα παράγωγά τους (Davies, 2022) [6]

Το φωτόνιο υψηλής ενέργειας που προκύπτει από την διάσπαση των ουδέτερων μεσονίων, γρήγορα μετατρέπεται σε ζευγάρι ηλεκτρονίου ποζιτρονίου, γνωστό και ως ζεύγος παραγωγής. Τα ζευγάρια ηλεκτρονίων ποζιτρονίων εκπέμπουν με τη σειρά τους φωτόνια και αυτά με πολύ υψηλή ενέργεια τα οποία υλοποιούνται σε ένα επιπλέον ζεύγος ηλεκτρονίου ποζιτρονίου. Αυτός ο ηλεκτρομαγνητικός καταιγισμός συνεχίζεται και διαιρεί την αρχική ενέργεια των φωτονίων ανάμεσα στα πολλαπλά ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια και χαμηλότερης ενέργειας φωτόνια. Φωτόνια με ενέργεια λιγότερη από 1,022 MeV δεν μπορούν να παράξουν ζεύγη και θα υποστούν σκέδαση *Compton* [7] και φωτοηλεκτρική απορρόφηση. Επιπλέον, σε χαμηλότερα υψόμετρα δεν υπάρχει πληθώρα ουδέτερων μεσονίων με υψηλή ενέργεια λόγω της απότομης μείωσης των πυρηνικών αλληλεπιδράσεων.

Τα μιόνια από κοσμικές ακτίνες μ[±] (Cosmic ray muons) τα οποία, είναι το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, προέρχονται από τη διάσπαση φορτισμένων μεσονίων. Ένα φορτισμένο πιόνιο θα διασπαστεί σε ένα ομόσημο μιόνιο με λόγο διάσπασης 99,98%, ενώ ένα φορτισμένο καόνιο διασπάται σε μιόνιο και νετρίνο μιονίου 63,5% κάθε φορά [8]. Τα νετρίνα δεν είναι φορτισμένα και μπορούν να αγνοηθούν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.

$$\pi^{\pm} \rightarrow \mu^{\pm} + \nu_{\mu} \left(\overline{\nu}_{\mu} \right) \qquad \varepsilon \xi. \ 2.1$$
$$K^{\pm} \rightarrow \mu^{\pm} + \nu_{\mu} \left(\overline{\nu}_{\mu} \right) \qquad \varepsilon \xi. \ 2.2$$

Περίπου το 80 - 90% της ροής μιονίων στην ενεργειακή κλίμακα που μας ενδιαφέρει (GeV - TeV) προέρχεται από την διάσπαση πιονίων [8], και το υπόλοιπο από καόνια. Τα μιόνια θεωρούνται αρκετά διεισδυτικά μιας και αλληλεπιδρούν κυρίως μέσω ιονισμού καθώς ταξιδεύουν μέσα από την ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να μπορούν να διαπεράσουν μεγάλο όγκο υλικού και, εν τέλη, να τα εντοπίσουμε στην επιφάνεια της Γης. Τα μιόνια έχουν μάζα 105,65 MeV και είναι ασταθή σωματίδια με χρόνο ημιζωής 2,2 x 10⁻⁶ s και διασπώνται σε ένα ηλεκτρόνιο και δύο νετρίνα.

$$\mu^{\pm} \to e^{\pm} + \nu_e(\overline{\nu}_e) + \nu_{\mu}(\overline{\nu}_{\mu}) \qquad \varepsilon \xi. 2.3$$

Ένα μιόνιο προερχόμενο από κοσμική ακτίνα με ενέργεια μεγαλύτερη από 2,4 GeV θα είναι επαρκώς σχετιστικό, δηλαδή, θα μπορεί να παρατηρηθεί από κάποιον στη Γη πριν διασπαστεί, μιας και ο χρόνος ημιζωής του θα έχει διασταλεί. Πρακτικά, το μήκος διάσπασης του μιονίου γίνεται 15 km. Επιπλέον, ένα μιόνιο θα χάσει 2 GeV ενέργειας λόγω ιονισμού κατά τη διάρκεια της πορείας του προς την επιφάνεια της Γης μέσα από την ατμόσφαιρα. Εξαιτίας των παραπάνω, σε συνδυασμό με την επιρροή του γεωμαγνητικού πεδίου και των ηλιακών ανέμων, υπολογίζεται πως το ενεργειακό φάσμα των μιονίων στην επιφάνεια της Γής θα είναι λίγο μεγαλύτερο από μερικά GeV. Συνήθως, αναφερόμαστε στη μέση ενέργεια κοσμικών ακτίνων από μιόνια στην επιφάνεια του πλανήτη μας να είναι περίπου στα 4 GeV [9]. Τα μιόνια που δεν "επιβιώνουν" το ταξίδι μέχρι την επιφάνεια της Γής, διασπώνται. Τα παφαγόμενα ηλεκτφόνια ή ποζιτφόνια στη πεφίπτωση ενός μ+ αναφέφονται και ως Michelle electrons [10].

2.1.2 Διακυμάνσεις στη ροή Μιονίων

Υπάφχουν πολλές αιτίες που σχετίζονται με τη θέση της Γης στο ηλιακό σύστημα και την σχέση της με τον Ήλιο και τα μαγνητικά τους πεδία αντίστοιχα. Συγκεκοιμένα υπάφχει η ασυμμετοία Ανατολής - Δύσης όπου η οοή μιονίων είναι μεγαλύτερη από τα δυτικά απ' ότι τα ανατολικά εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου της Γης. Αυτό συμβαίνει καθώς τα σωματίδια ποοερχόμενα από κοσμικές ακτίνες είναι κατά κόρον θετικά φορτισμένα. Στη ορή επίσης επιδρά και το γεωγραφικό πλάτος. Το μαγνητικό πεδίο της Γης έχει παρόμοια συμπεριφορά με αυτή ενός μαγνητικού διπόλου προσανατολισμένο από βορρά πος νότο. Το μαγνητικό πεδίο έχει φορά παράλληλη με την επιφάνεια της Γης και κάθετο κοντά στους πόλους, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2:



Σχήμα 2.3 Αναπαράσταση του Μαγνητικού Πεδίου της Γης | NASA (Representation of Earth's Invisible Magnetic Field, 2011) [11]

Επομένως, τα σωματίδια που ταξιδεύουν από το σύμπαν προς τη Γη, εάν

πλησιάσουν τους πόλους, θα εκτραπούν από τη πορεία τους σε αντίθεση με το αν πλησίαζαν τον ισημερινό, λόγω της παρακάτω σχέσης:

$$\vec{F} = q\vec{u} \times \vec{B}$$
 $\varepsilon \xi. 2.4$

Υπά χουν και τοπικές μαγνητικές ανωμαλίες στην επιφάνεια της Γης που επηρεάζουν τη ροή μιονίων. Πιο χαρακτηριστική είναι η Ανωμαλία Νότιου Ατλαντικού (South Atlantic Anomaly - SAA) που εκτείνεται από τη Βραζιλία μέχρι τις δυτικές ακτές της Αφρικής. Σε αυτό το σημείο, η εσωτερική ζώνη ακτινοβολίας Van Allen έρχεται πλησιέστερα στην επιφάνεια της Γης, συγκεκριμένα κοντά στα 200 km και ενισχύεται κατά πολύ η ροή φορτισμένων σωματιδίων όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.3 παρακάτω. Είναι γνωστό ότι έχουν προκληθεί πολλές βλάβες σε ηλεκτρονικά συστήματα λόγω αυξημένης ακτινοβολίας σε δορυφόρους και στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όποτε διέρχονται πάνω από αυτή τη περιοχή [12].



Σχήμα 2.4 Christopher C. Finlay, Clemens Kloss, Nils Olsen, Magnus D. Hammer, Lars Tøffner-Clausen, Alexander Grayver & Alexey Kuvshinov [13]

Ο Ήλιος έχει διάρκεια κύκλου δραστηριότητας κάθε 11 χρόνια και ανάλογα με την ένταση της επηρεάζει και τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Επιπλέον, οι ηλιακές εκλάμψεις εκκρίνουν πρωτόνια με ενέργειες έως μερικά GeV τα οποία είναι επαρκή να παράξουν μιόνια μέσω πυρηνικών αλληλεπιδράσεων.

Παραπάνω, αναλύσαμε τις τυχόν διακυμάνσεις στη ροή της ακτινοβολίας λόγω παραγόντων εκτός του πλανήτη μας, παρακάτω θα αναλύσουμε τυχόν διακυμάνσεις που μπορούμε να εντοπίσουμε στις ροές μιονίων λόγω επίγειων φαινομένων. Συγκεκριμένα, σε μεγάλες γωνίες λήψης τα μιόνια θα πρέπει να ταξιδέψουν μέσα από περισσότερη ατμόσφαιρα και άρα μάζα μέχρι την επιφάνεια της Γης. Μια κοσμική ακτίνα όταν ταξιδεύει κάθετα, αρκεί να διανύσει απόσταση 15 km, ωστόσο όταν οδεύει υπό γωνία, μπορεί να χρειαστεί να διασχίσει μέχρι και 500 km. Η μεγαλύτερη απόσταση αυτόματα σημαίνει μεγαλύτερη απώλεια ενέργειας λόγω ιονισμού στην ατμόσφαιρα και άρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα διάσπασης μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια της Γης και άρα να εντοπιστεί από κάποιον ανιχνευτή.

Η θεομοκοασία της ατμόσφαιοας παίζει επίσης σημαντικό οόλο, καθώς όταν έχουμε υψηλές θεομοκοασίες η ατμόσφαιοα διαστέλλεται και γίνεται πιο αοαιή με αποτέλεσμα να υπάοχουν πεοισσότεοα σωματίδια με τα οποία μποοεί να υπάοξει αλληλεπίδοαση και άρα μικοότεοη πιθανότητα να διασπαστούν οι εισεοχόμενες κοσμικές ακτίνες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν η ατμόσφαιοα είναι πιο ψυχοή, λεπτή και πυκνή, οι αλληλεπιδοάσεις των κοσμικών ακτίνων λαμβάνουν μέρος πλησιέστεοα στην επιφάνεια της Γης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα φορτισμένα μεσόνια να χάνουν ενέργεια πολύ γρήγορα και άρα να έχουν μικοότεοη πιθανότητα να διασπαστούν σε μιόνια.

2.2 Αλληλεπίδοαση ακτινοβολίας με την ύλη

Η λειτουργία κάθε ανιχνευτικού συστήματος βασίζεται στην αλληλεπίδραση των διερχόμενων σωματιδίων με το υλικό του ανιχνευτή. Το προϊόν της αλληλεπίδρασης μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα το οποίο έπειτα μπορούμε να μετρήσουμε και να εξάγουμε συμπεράσματα.

2.2.1 Βαρέα φορτισμένα σωματίδια

Η αλληλεπίδραση βαρέων φορτισμένων σωματιδίων με την ύλη πραγματοποιείται μέσω της δύναμης Coulomb με τα περιφερειακά ηλεκτρόνια και με τον πυρήνα του ατόμου.

Οι απώλειες ενέργειας προκύπτουν από:

- Διέγερση: ένα ατομικό ηλεκτρόνιο αποκτά ενέργεια ικανή για τη μετάβασή του σε μια ανώτερη ενεργειακή στάθμη.
- Ιονισμός: παρόμοια με τη διέγερση, ένα ηλεκτρόνιο αποκτά ενέργεια ικανή να του επιτρέψει να εγκαταλείψει το άτομο στο οποίο προηγουμένως ήταν δέσμιο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ζεύγους θετικού ιόντος και ελεύθερου ηλεκτρονίου.
- 3. Ακτινοβολία Cherenkov: συμμετέχει λιγότερο στην απώλεια ενέργειας, όμως είναι μεγάλης σημασίας για τον καθορισμό της τροχιάς ενός φορτισμένου σωματιδίου. Εκπέμπεται, όταν ένα φορτισμένο σωματίδιο περνά μέσα από ένα διηλεκτρικό μέσο με ταχύτητα μεγαλύτερη της φασικής ταχύτητας του φωτός στο μέσο αυτό. Το φορτισμένο σωματίδιο σε τροχιά, εκπέμπει σφαιρικά ηλεκτρομαγνητικά κύματα μέσω της δημιουργίας ηλεκτρικών διπόλων.
- 4. Ακτινοβολία μετάβασης: εκπέμπεται όταν ένα σωματίδιο διασχίζει τη διαχωριστική επιφάνεια δύο μέσων με διαφορετικές διηλεκτρικές ιδιότητες. Η αλλαγή της διηλεκτρικής σταθεράς, κατά μήκος της τροχιάς του σωματιδίου, προκαλεί ασυνέχεια του ηλεκτρικού πεδίου στη διαχωριστική επιφάνεια.

2.2.2 Ταχέα ηλεκτοόνια

Τα ταχέα ηλεκτρόνια υπόκεινται σε μικρότερη απώλεια ενέργειας και η τροχιά τους είναι τυχαία και μη γραμμική, όταν διέρχονται μέσα από απορροφητικά υλικά. Οι απώλειες ενέργειας προκύπτουν από:

- Σκέδαση με περιφερειακά ηλεκτρόνια: λόγω της αλληλεπίδρασης Coulomb, φαινόμενα διέγερσης και ιονισμού λαμβάνουν χώρα, με αποτέλεσμα να χάνει ενέργεια και να αποκλίνει από την αρχική του τροχιά. Εάν η αρχική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι αρκετά μεγάλη, μπορούν να προκληθούν και δευτερεύοντες ιονισμοί.
- 2. Ακτινοβολία πέδησης (bremsstrahlung): αποτελεί ηλεκτφομαγνητική ακτινοβολία παφαγόμενη από την επιβφάδυνση ενός φοφτισμένου σωματιδίου (ηλεκτφόνιο) όταν εκτφέπεται λόγω ενός άλλου φοφτισμένου σωματιδίου (ατομικός πυφήνας). Λόγω της διατήφησης της ενέφγειας, η κινητική ενέφγεια που χάνεται μετατφέπεται σε ένα φωτόνιο.
- 3. Σκεδάσεις Moller και Bhabha: εμπεριέχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ προσπιπτόντων ηλεκτρονίων ή ποζιτρονίων με ατομικά ηλεκτρόνια. Στην κβαντική χρωμοδυναμική, η σκέδαση Moller περιγράφει την άπωση δύο ηλεκτρονίων, ενώ η σκέδαση Bhabha περιγράφει την έλξη μεταξύ ηλεκτρονίου και ποζιτρονίου.

2.2.3 Φωτόνια

Οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης των φωτονίων οδηγούν στη μεταφορά ενέργειας φωτονίου, μερικής ή ολικής, στα ατομικά ηλεκτρόνια του μέσου, η οποία εμφανίζεται ως κινητική ενέργεια.

Οι κύριοι τρόποι αλληλεπίδρασής τους με την ύλη είναι:

- Σύμφωνη σκέδαση (Rayleigh): το εισερχόμενο φωτόνιο απορροφάται και επανεκπέμπεται αμέσως χωρίς απώλεια ενέργειας, παρά μόνο αλλαγή κατεύθυνσης.
- 2. Ασύμφωνη σκέδαση (Φωτοηλεκτοικό φαινόμενο): αφορά την αλληλεπίδραση φωτονίων ενέργειας συνήθως μικρότερης του 1 MeV με ατομικά ηλεκτρόνια. Η ενέργεια του απορροφούμενου φωτονίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη της ενέργειας σύνδεσης των ηλεκτρονίων.

Δημιουργείται ένα εξαγόμενο φωτοηλεκτρόνιο και ένα ιονισμένο άτομο στον απορροφητή, το οποίο έχει ένα κενό στις στοιβάδες του.

- 3. Σκέδαση Compton: περιγράφει την ανελαστική σκέδαση ενός φωτονίου σε γωνία θ από ένα ατομικό ηλεκτρόνιο, συνήθως ασθενώς συνδεδεμένο στο άτομο. Ένα ποσό κινητικής ενέργειας φωτονίου μεταβιβάζεται στο ηλεκτρόνιο, το οποίο μετά τη σκέδαση κινείται υπό γωνία φ σε σχέση με τον αρχικό άξονα του φωτονίου.
- 4. Δίδυμη γένεση: ένα φωτόνιο μετατρέπεται σε ζεύγος ηλεκτρονίου ποζιτρονίου. Απαιτείται μια ελάχιστη ενέργεια, ίση με το διπλάσιο της μάζας ηρεμίας του ηλεκτρονίου (1,02 MeV), ενώ πιθανή περίσσεια ενέργεια διανέμεται ισόποσα στα επιμέρους σωματίδια με τη μορφή κινητικής ενέργειας. Μετά τη δίδυμη γένεση, το ποζιτρόνιο χάνει ενέργεια και εξαϋλώνεται αφού προσεγγίσει ένα ηλεκτρόνιο.

2.2.4 Νετοόνια

Τα νετφόνια, ως αφόφτιστα σωματίδια, δε μποφούν να καμφθούν ή να επιταχυνθούν από μαγνητικό πεδίο και επίσης είναι αδύνατη η ανίχνευσή τους, μέσω ιονισμού των υλικών μέσα από τα οποία διέφχονται. Η πιθανότητα αλληλεπίδφασής του είναι μικφή κι έτσι μποφούν να ταξιδεύουν μακφιά μέσα στην ύλη.

Οι κύφιοι τφόποι αλληλεπίδφασής τους με την ύλη είναι:

- Ελαστική σκέδαση νετοονίου πυρήνα: είναι ο κυριότερος μηχανισμός απώλειας ενέργειας για νετρόνια ενέργειας της τάξεως των MeV. Η ενέργεια και η ορμή στο σύστημα νετρονίου – πυρήνα διατηρείται.
- Ανελαστική σκέδαση νετρονίου πυρήνα: το νετρόνιο απορροφάται από τον πυρήνα και τον διεγείρει. Ο νέος πυρήνας αποδιεγείρεται με την εκπομπή ενός νετρονίου χαμηλής ενέργειας συνοδευόμενο από φωτόνια.

- Μη ελαστική σκέδαση: όπως στην ανελαστική σκέδαση, όμως αντί για νετρόνιο εκπέμπεται ένα σωμάτιο άλφα.
- Απορρόφηση με εκπομπή γ: το νετρόνιο ενσωματώνεται στον πυρήνα δημιουργώντας ισότοπο σε διεγερμένη κατάσταση, το οποίο αποδιεγείρεται με εκπομπή φωτονίων.
- Απορρόφηση με εκπομπή φορτισμένων σωματιδίων: ο σύνθετος πυρήνας αποδιεγείρεται με εκπομπή πρωτονίου, δευτερίου ή σωματιδίου άλφα.
- 6. Απορρόφηση με εκπομπή νετρονίων: για υψηλής ενέργειας προσπίπτοντα νετρόνια, η αποδιέγερση του σύνθετου πυρήνα επιτυγχάνεται με την εκπομπή δύο ή τριών νετρονίων.
- 7. Πυρηνική σχάση: η απορρόφηση νετρονίου οδηγεί τον πυρήνα σε ασταθή κατάσταση με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός θυγατρικού πυρήνα μαζί με άλλα θραύσματα.
- Σχηματισμός αδουικών πιδάκων: νετρόνια ενέργειας άνω των 100 MeV συγκρούονται με πυρήνα – στόχο με αποτέλεσμα τη θραύση του.

2.2.5 Καταιγισμοί

Τέλος, οι καταιγισμοί είναι ένας ακόμη μηχανισμός αλληλεπίδοασης. Κατά τη διάρκεια ενός ηλεκτορμαγνητικού καταιγισμού, ένα φωτόνιο με ενέργεια μεγαλύτερη από ένα κοίσιμο όριο, παράγει ένα ζεύγος e⁺e⁻ μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται δίδυμη γένεση, η οποίο μπορεί να παράξει εκ νέου φωτόνια μέσω ακτινοβολίας πέδησης, αν υπάρχει επαρκής ενέργεια. Τα νέα αυτά φωτόνια μπορούν να παράξουν ξανά ζεύγη e⁺e⁻ και η διαδικασία παραγωγής σωματιδίων σταματά, όταν η ενέργεια πέσει κάτω από ένα κρίσιμο κατώφλι. Κεφάλαιο 3

State of the art

3.1 Ανιχνευτές Ακτινοβολιών

Κατά τη διάφκεια της ιστοφίας έχουν κατασκευαστεί διάφοφες συσκευές για την ανίχνευση της ακτινοβολίας, αυτές οι συσκευές χφησιμοποιούνται για μια πληθώφα εφαφμογών όπως ιατφικές διαγνώσεις, μετφήσεις χφονολόγησης με ενεφγό άνθφακα ή γενικά μέτφηση ακτινοβολίας στο πεφιβάλλον. Στις παφακάτω σελίδες αναλύουμε μεφικές από αυτές τις συσκευές.

3.1.1 Απαριθμητής Geiger

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1, ο απαριθμητής Geiger είναι ίσως η πιο διαδεδομένη συσκευή για την ανίχνευση της ραδιενέργειας. Θεωρείται το πρωτότυπο όλων των απαριθμητών, που κάνουν χρήση του ιονισμού ενός μέσου, ως βασική διεργασία ανίχνευσης. Η διάταξη αποτελείται από έναν κυλινδοικό μεταλλικό σωλήνα, γεμάτο με αέοιο σε χαμηλή πίεση και ένα σύρμα κατά μήκος του άξονα του σωλήνα. Το σύρμα διατηρείται σε υψηλό θετικό δυναμικό (περίπου 10³ V) σε σχέση με τον σωλήνα και όταν ένα σωματίδιο ή φωτόνιο υψηλής ενέργειας εισέρχεται στον σωλήνα, δια μέσου ενός μικρού "παραθύρου" στο ένα του άκρο, μερικά από τα άτομα του αερίου ιονίζονται. Τα ηλεκτρόνια που αποσπώνται από τα άτομα έλκονται προς το θετικό σύρμα και στη πορεία ιονίζουν τα άτομα που συναντούν στη διαδρομή τους. Η αλυσιδωτή διαδικασία προκαλεί μια χιονοστιβάδα ηλεκτρονίων, η οποία, τελικά, παράγει έναν παλμό ρεύματος στην έξοδο του σωλήνα. Αφού ενισχυθεί ο παλμός αυτός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θέσει σε λειτουργία έναν ηλεκτρονικό μετρητή ή να διοχετευθεί σε ένα μεγάφωνο, το οποίο ηχεί κάθε φορά που ένα σωματίδιο εισέρχεται στον ανιχνευτή.



Σχήμα 3.1 Διάγραμμα απαριθμητή Geiger. Η διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού μεταξύ του σύρματος και του μεταλλικού σωλήνα είναι συνήθως 1.000V [14]

3.1.2 Ανιχνευτής με δίοδο ημιαγωγού

Ο ανιχνευτής με δίοδο ημιαγωγού είναι, κυρίως, μια επαφή *p-n* υπό ανάστροφη πόλωση. Μία δίοδος επαφής *p-n* διαρρέεται εύκολα από ρεύμα όταν πολώνεται ορθά και δεν επιτρέπει τη ροή ρεύματος υπό συνθήκες ανάστροφης πόλωσης. Όταν ένα ενεργητικό σωματίδιο διέρχεται από την επαφή, τα ηλεκτρόνια σθένους διεγείρονται και ανέρχονται στη ζώνη αγωγιμότητας και ίσος αριθμός οπών δημιουργούνται στη ζώνη σθένους. Το εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο παρασύρει τα ηλεκτρόνια προς τη θετική πλευρά (*n*) της επαφής και τις οπές προς την αρνητική πλευρά (*p*). Αυτό δημιουργεί έναν παλμό ρεύματος, ο οποίος μπορεί να μετρηθεί. Σε μια τυπική συσκευή, ο παλμός διαρκεί 10⁻⁷ με 10⁻⁸s.

3.1.3 Σπινθηριστές

Ο απαφιθμητής σπινθηφισμών αποτελείται συνήθως, από ένα στέφεο ή υγφό υλικό του οποίου τα άτομα αποφφοφούν ενέφγεια και την επανεκπέμπουν με τη μοφφή ηλεκτφομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι σπινθηφιστές μποφούν να αναπτυχθούν σε εφγαστήφια ως κφύσταλλοι και ανήκουν στη κατηγοφία των μη-οργανικών σπινθηφιστών και γενικά είναι πιο ακφιβοί, ωστόσο λόγω της μεγαλύτεφης πυκνότητάς τους εκπέμπουν πεφισσότεφα φωτόνια ανά μονάδα ενέφγειας που έλαβαν. Οι οφγανικοί σπινθηφιστές είναι από πλαστικό υλικό π.χ. ακφυλικό και στους οποίους έχει γίνει πφόσμιξη φθοφίζων υλικού, είναι πιο φθηνοί μιας και το κόστος κατασκευής τους είναι μικφότεφο.

Η ποιότητα, συνεπώς και η αξία ενός σπινθηφιστή, καθοφίζεται από το πόσα φωτόνια εκπέμπει ανά MeV αποφφοφούμενης ενέφγειας. Ένας κοινός οφγανικός σπινθηφιστής έχει αποδοτικότητα 10.000 φωτόνια/MeV.

Στην παφούσα διπλωματική εφγασία χφησιμοποιήσαμε έναν οφγανικό πλαστικό σπινθηφιστή BC-408 με πολυστυφένια (polystyrene) βάση. Σύμφωνα με την εταιφεία παφαγωγής "Saint-Gobain Crystals" οι σπινθηφιστές BC-408 είναι ιδανικοί για γενική χφήση, για ανίχνευση <100keV X-rays, alphas, betas, φοφτισμένα σωματίδια, κοσμικές ακτίνες, μιονίων, πφωτονίων και νετφονίων [15]. Στο παρακάτω σχήμα μπορούμε να δούμε και το μήκος κύματος όπου έχει τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα εκπομπής.



Σχήμα 3.2 Μήκος κύματος συναρτήσει της μέγιστης εκπομπής (nm) (BC-408 Datasheet, n.d.) [16]

ъ <i>к</i>	/ < /	D/	C100	17		/	/
NIEC	μκές ιδιότι	ητες του Βί	408 $\pi \alpha \alpha$	$\Omega (\alpha (\alpha) \tau \alpha)$	$\sigma \tau \alpha \pi \alpha$	οακατω	πινακα
TATCE		100 00	C100 100	500 101 90 1 1011	0101 1101	guinerie	

Πυκνότητα, g/cc	1,032
Δείκτης διάθλασης	1,58
Χρόνος ανόδου, ns	0,9
Χρόνος διάσπασης, ns	2,1
Πλάτος Παλμού, FWHM, ns	~2,5
Μήκος κύματος μέγιστης εκπομπής, nm	425
Αριθμός ατόμων Η ανα cm³	5,23
Αριθμός ατόμων C ανα cm³	4,74
Λόγος ατόμων Η:C	1,104
No. of Electrons per cm ³ x10 ²³	3.37

Пі́vакаς 3.1 BC-408 Datasheet, n.d. [16]

Στην παρούσα εργασία ενώσαμε τον σπινθηριστή με έναν

φωτοπολλαπλασιαστή SiPM (αναλύεται στο <u>3.2.3</u>) και προσθέσαμε βαζελίνη για να μην υπάρχει αέρας ανάμεσα στα δύο υλικά και ουσιαστικά να ταυτιστεί ο δείκτης διάθλασης του υλικού της πλακέτας με αυτόν του σπινθηριστή.

Η προσαρμογή του σπινθηριστή στο όργανο αναλύεται περαιτέρω στο <u>Κεφάλαιο 4</u>.

3.1.4 Φωτογραφικό Γαλάκτωμα

Οι παραπάνω συσκευές που αναλύσαμε κάνουν κυρίως χρήση διεργασιών ιοντισμού οι οποίες προκαλούνται από φορτισμένα σωματίδια. Ωστόσο, υπάρχουν συσκευές που μας επιτρέπουν να δούμε άμεσα τις διαδρομές των φορτισμένων σωματιδίων. Ένα φορτισμένο σωματίδιο, που προσπίπτει σε ένα στρώμα γαλακτώματος, ιονίζει τα άτομά του και η διαδρομή του σωματιδίου αντιστοιχεί σε μια σειρά σημείων στα οποία έχουν συμβεί χημικές αλλαγές στο γαλάκτωμα. Όταν εμφανίσουμε το γαλάκτωμα, η διαδρομή του εκάστοτε σωματιδίου γίνεται ορατή.

3.1.5 Θάλαμος Νέφους

Ο Θάλαμος Νέφους [17] ή και γνωστός ως Θάλαμος Wilson, περιέχει ένα αέριο το οποίο έχει υπέρψυχθεί και βρίσκεται μόλις λίγο κάτω από το συνηθισμένο σημείο συμπύκνωσης του. Ένα ενεργητικό σωματίδιο που διέρχεται δια μέσου του αερίου ιοντίζει το αέριο σε όλο το μήκος της τροχιάς. Αυτά τα ιόντα παίζουν το ρόλο των κέντρων συμπύκνωσης του ψυχθέντος αερίου. Η τροχιά είναι ορατή με γυμνό μάτι και μπορεί φυσικά να φωτογραφηθεί. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και μαγνητικό πεδίο και να προσδιοριστούν έτσι τα πρόσημα των φορτίων που εισέρχονται στον θάλαμο ανάλογα με το πως εκτρέπονται από το πεδίο, όπως φαίνεται στη φωτογραφία παρακάτω:



Σχήμα 3.3 Τροχιές σωματιδίων μέσα σε θάλαμο Νέφους (Fraser, 2002) [17]

3.1.6 Θάλαμος Σπινθήρων

Ο Θάλαμος Σπινθήφων είναι μια συσκευή μέτφησης η οποία αποτελείται από μια σειφά αγώγιμων παφάλληλων πλακών. Οι πλάκες με ζυγό αφιθμό γειώνονται και οι πλάκες με μονό αφιθμό διατηφούνται σε πολύ υψηλό δυναμικό της τάξης των 10 kV. Τα διαστήματα μεταξύ των πλακών πεφιέχουν ένα ευγενές αέφιο σε ατμοσφαιφική πίεση. Όταν ένα φοφτισμένο σωματίδιο διέφχεται δια μέσου του θαλάμου, πφοκαλείται ιοντισμός στο αέφιο και έχουμε ως αποτέλεσμα μια μεγάλη φιπή ηλεκτφικού φεύματος και έναν οφατό σπινθήφα.

3.2 Ανιχνευτές Μεμονωμένων Φωτονίων

Η τεχνολογία ανίχνευσης φωτονίων έχει ένα ευού φάσμα εφαομογών στην ιατοική (medical imaging), στην ανίχνευση ακτινοβολίας, φασματογοαφία, εποπτικό έλεγχο μέχοι και στη μετεωοολογία. Για όλες τις παοαπάνω εφαομογές απαιτείται η ποσοτικοποίηση και ο καθοοισμός της χοονικής στιγμής ενός σήματος φωτός από 1 έως 1000 φωτόνια ανά γεγονός. Ο ιδανικός ανιχνευτής θα πρέπει να:

- 1. μας τροφοδοτεί ένα σήμα ανάλογο της ροής φωτονίων που λαμβάνει
- 2. μας προσφέρει χρόνους απόκρισης στα σήματα της τάξης των nanosecond
- 3. αποκρίνεται σε ευρύ φάσμα μηκών κύματος
- 4. είναι στιβαρός
- 5. είναι εύκολος στη χρήση
- 6. παράγει διαχειρίσιμο θόρυβο

3.2.1 Φωτοπολλαπλασιαστής σε σωλήνα (Photomultiplier Tube ή PMT)

Μέχοι σήμερα ο φωτοπολλαπλασιαστής σε σωλήνα (Photomultiplier Tube ή PMT) ήταν η βασική επιλογή σε αντίστοιχα πειράματα, μιας και ήταν μια καθιερωμένη τεχνολογία και ευρέως διαθέσιμη σωλήνα κενού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.4.



Σχήμα 3.4 Ένας τυπικός Φωτοπολλαπλασιαστής σε σωλήνα [21]

Η ημιδιαφανής φωτοκάθοδος στο εσωτεφικό του σωλήνα πεφιοφίζει την αποδοτικότητα του ανιχνευτή (PDE: Photo Detection Efficiency, βλ. 3.2.4.3), συνήθως η αποδοτικότητα κυμαίνεται στο 20% στα 420 nm. Το κέφδος 1-10⁶ έφχεται σε κόστος υψηλής τάσης πόλωσης, η οποία κυμαίνεται στα 1-2 kV και πφοϋποθέτει τη χφήση διατάξεων υψηλών τάσεων. Τα PMT's θεωφούνται στιβαφές συσκευές με χαμηλό θόφυβο αλλά καταλαμβάνουν χώφο και είναι θεωφούνται ευαίσθητες κυφίως λόγω του κενού αέφος που διαθέτουν στο εσωτερικό τους, επίσης μπορούν να επηρεαστούν και από μαγνητικά πεδία γεγονός που περιορίζει τη χρήσης τους σε ορισμένες εφαρμογές.

3.2.2 PIN Diodes & Avalanche Photodiodes (APD's)

Οι συσκευές στεφεάς κατάστασης έχουν πολλά πφακτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το PMT, και αυτό οδήγησε στην ευφεία χφήση της διόδου PIN (*Pin Diode*) σε εφαφμογές όπου το PMT ήταν πολύ ογκώδες, ευαίσθητο ή απαιτούνταν χαμηλότεφες τάσεις. Ο βασικός πεφιοφισμός των διόδων PIN είναι η απουσία εσωτεφικής ενίσχυσης. Έτσι αναπτύχθηκαν τα *Avalanche Photodiodes* ή αλλιώς *APD's* τα οποία είναι πιο σύγχφονα και θεωφούνται ως εξέλιξη των *PIN Diode*, όπως φαίνονται στο σχήμα 3.5:



 $Σ_{\chi \eta \mu \alpha} 3.5$ Ανιχνευτές Avalanche Photodiodes (APD) [21]

Σε αυτά, η ανάστοοφη τάση πόλωσης ανέρχεται σε ένα σημείο όπου ο ιοντισμός επιτρέπει εσωτερικό πολλαπλασιασμό αλλά είναι ταυτόχρονα κάτω από το κατώφλι πόλωσης όπου θα επικρατούσε η μέθοδος Geiger. Έτσι επιτυγχάνεται κέρδος της τάξης του 100 με τάση πόλωσης 100 - 200 V. Με ειδικό σχεδιασμό είναι δυνατόν να επιτευχθεί κέρδος μερικών χιλιάδων με τάση πόλωσης HV > 1500 V. Αν και το κέρδος μπορεί να είναι χαμηλότερο από αυτό του PMT, τα APD's πλεονεκτούν στο γεγονός ότι έχουν Photo Detection Efficiency > 65% και ταυτόχρονα έχουν πολύ μικρότερο μέγεθος, στιβαρότητα και δεν επηρεάζονται από μαγνητικά πεδία. Το βασικό τους μειονέκτημα είναι ο θόφυβος που παφάγουν και ο πεφιοφισμός τους στο μέγεθος μιας και έχουν ~10 mm διάμετφο.

3.2.3 Φωτοπολλαπλασιαστής Πυριτίου (Silicon Photomultiplier ή SiPM)

Ο φωτοπολλαπλασιαστής πυριτίου (Silicon Photomultiplier ή SiPM) χαρακτηρίζεται από υψηλό κέρδος και μέτριο PDE (~20%) νούμερο πολύ κοντά στο ΡΜΤ, αλλά συνδυάζει το μικρό μέγεθος, τη στιβαρότητα και την μη-επιρροή από μαγνητικά πεδία των PIN & APD's. Επιπλέον, το SiPM επιτυγχάνει υψηλό κέρδος της τάξης του (1e⁶) με πολύ χαμηλές τάσεις πόλωσης (~30 V) και ο θόρυβος διακρίνεται μόνο στο επίπεδο του μεμονωμένου φωτονίου. Λόγω του μεγάλου βαθμού ομοιογένειας ανάμεσα στις μικροκυψέλες του SiPM, έχει τη δυνατότητα να διακρίνει τον ακριβή αριθμό φωτοηλεκτρονίων, που ανιχνεύονται σε διακριτό επίπεδο στην έξοδο του. Η δυνατότητα να μετρήσουμε ένα ευρύ φάσμα φωτοηλεκτρονίων είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του SiPM, το οποίο δε μπορούμε να βρούμε σε άλλους ανιχνευτές, εξαιτίας της διακύμανσης του κέρδους και του μεγάλου θορύβου. Παρά το γεγονός ότι οι SiPM είναι ευαίσθητοι σε μεμονωμένα φωτόνια, ο $gu\theta\mu$ ός dark count των ~100 KHz/mm² σε θε $g\mu$ οκρασία δωματίου τον καθιστούν ανεπαρκή για χρήση σε χώρο με πολύ χαμηλά επίπεδα φωτός. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα 4 είδη ανιχνευτών και οι επιμέρους ιδιότητές τους [18].

	PIN	APD	PMT	SPM
Gain	1	10 ²	10 ⁶	10 ⁶
Operational Bias	Low	High	High	Low**
Temp. Sensitivity	Low	High	Low	Low
Mechanical Robustness	High	Medium	Low	High
Ambient light exposure?	OK	OK	NO	ОК
Spectral range	Red	Red	Blue/UV	Green
Readout / Electronics	Complex	Complex	Simple	Simple
Form factor	Compact	Compact	Bulky	Compact
Large area available?	No	No	Yes	Yes
Sensitive to magnetic fields?	Yes*	Yes*	Yes	No
Noise	Low	Medium	Low	High
Rise time	Medium	Slow	Fast	Fast

* Due to the requirement for the external electronics to be located close to the detector

** SPM from SensL, having an operational bias of 30V, meet the requirements of the Extra Low Voltage directive

Πίνακας 3.2 Πίνακας σύγκρισης των ανιχνευτών (Dieguez, n.d.) [20]

Όταν ένα φωτόνιο ταξιδεύει μέσα από το πυρίτιο μεταφέρει την ενέργειά του σε ένα bound state electron μεταφέροντάς το στη ζώνη αγωγιμότητας, δημιουργώντας έτσι ένα ζευγάρι οπής. Το απορροφημένο μήκος ενός φωτονίου μέσα στο πυρίτιο εξαρτάται από την ενέργεια του ή το μήκος κύματος και φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:



Σχήμα 3.6 Απορροφητικότητα φωτονίων στο πυρίτιο [21]

Απο το παραπάνω διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι το πυρίτιο θεωρείται ιδανικό υλικό ανίχνευσης φωτονίων στο φάσμα 350 nm - 800 nm. Για μήκη κύματος

πάνω από 1000 nm το μήκος απορρόφησης (Absorption length - κάθετη στήλη y) γίνεται τόσο μεγάλο και ο ανιχνευτής θα χρειαστεί να έχει πολύ μεγάλο όγκο καθιστώντας τον, δύσχρηστο. Αντίστοιχα για μήκη κύματος μικρότερα των 350 nm ο ανιχνευτής θα πρέπει να είναι πολύ λεπτός. Για ευκολία από εδώ και στο εξής θα αναφερόμαστε στον Φωτοπολλαπλασιαστή Πυριτίου ως SiPM (Silicon Photomultiplier)

3.2.3.1 The Geiger Mode in Silicon

Οταν ένα επαφκώς έντονο ηλεκτφικό πεδίο (>5 x 10⁵ V/cm) παφάγεται στη πεφιοχή απογύμνωσης του πυφιτίου, ένας φοφέας φοφτίου που δημιουφγείται σε αυτή τη πεφιοχή θα επιταχυνθεί σε σημείο όπου διαθέτει τόση κινητική ενέφγεια, αφκετή για να δημιουφγήσει ένα νέο, δευτεφεύον φοφτισμένο ζευγάφι, αυτή η διαδικασία ονομάζεται *Ιοντισμός μέσω πρόσκρουσης*. Με αυτή τη διαδικασία, ένα μεμονωμένο φωτοηλεκτφόνιο μποφεί να είναι η αφχή της δημιουφγίας μιας συνεχόμενης χιονοστιβάδας ιοντισμού του υλικού, που θα εξαπλωθεί σε όλο το πυφίτιο που βφίσκεται υπό την επιφφοή του ηλεκτφικού πεδίου. Το πυφίτιο έπειτα θα γίνει αγώγιμο και με τη σειφά του θα ενισχύσει το αφχικό φωτοηλεκτφόνιο σε μακφοσκοπική φοή φεύματος. Η παφαπάνω διαδικασία ονομάζεται αποφόφτιση *Geiger Discharge*) και οπτικοποιείται με το Σχήμα 3.7 παφακάτω:


Σχήμα 3.7 (α) Σχήμα του Geiger Mode. Σχήμα (β) "Ψηφιακός" παλμός εξόδου από μια φωτοδίοδο που λειτουργεί σε Geiger Mode [19]

Επομένως, μια συσκευή που δοα σε λειτουογία Geiger Mode είναι, ποακτικά, ένας "διακόπτης" που ενεογοποιείται με τη παοουσία φωτονίων, μιας και βοίσκεται σε μια κατάσταση 'on' ή 'off', όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.7 (β). Η έξοδος που λαμβάνουμε είναι ανεξάρτητη της ποσότητας των φωτονίων που εντοπίζει, το σήμα θα είναι πάντα 0 ή 1, δηλαδή απουσία ή παοουσία φωτονίων αντίστοιχα.

3.2.3.2 Φωτοπολλοπλασιαστής Πυριτίου

Για να ξεπεφαστεί το πφόβλημα της ποσοτικοποίησης των εισεφχόμενων φωτονίων αναπτύχθηκε ο Φωτοπολλοπλασιαστής Πυφιτίου, ο οποίος αποτελείται από μια πυκνή διάταξη μικφοσκοπικών φωτοδιόδων Geiger Mode οπτικά και ηλεκτφονικά απομονωμένων. Κάθε στοιχείο της διάταξης αναφέφεται ως μικφοκυψέλη, σε πλήθος συνήθως ανάμεσα σε 100 - 1000 ανά mm². Τα σήματα όλων των μικφοκυψελών αθφοίζονται και αποτελούν την τελική έξοδο του SiPM όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.8 παφακάτω.



Σχήμα 3.8 Διάταξη μικροκυψελών με τη τελική έξοδο του σήματος (MICROC-SERIES -Silicon Photomultipliers (SiPM), Low-Noise, Blue-Sensitive, n.d.) [19].

Επομένως, αφού κάθε μικοοκυψέλη εντοπίζει μεμονωμένα γεγονότα φωτονίων, το διακοιτό άθοοισμα των εκφορτίσεων της εκάστοτε μικοοκυψέλης μας δίνει πληροφορίες για τη ροή φωτονίων σε ολόκληρη την επιφάνεια της διάταξής μας. Στο Σχήμα 3.9 φαίνεται η απόκοιση του συστήματος σε χαμηλής έντασης παλμούς φωτός.



Σχήμα 3.9 Στιγμιότυπο από παλμογράφο όπου φαίνεται η διακριτή φύση των αποκρίσεων του SiPM, όταν εκτίθεται σε χαμηλής έντασης φωτεινούς παλμούς. [19]

3.2.4 Επίδοση και Τεχνικά χαρακτηριστικά του Φωτοπολλαπλασιαστή Πυριτίου MicroFC 60035 C-Series

Στη διαταξή μας, χρησιμοποιούμε τον MicroFC 60035 C-Series [19] από την εταιρία onsemi [20] και είναι το πιο ακριβό στοιχείο της κατασκευής καθώς, ο αισθητήρας αποτελεί το πιο καθοριστικό στοιχείο. Ο παραπάνω αισθητήρας είναι πιο ευαίσθητος στο μήκος κύματος των 450 nm, που σε ορατή ακτινοβολία είναι το βαθύ μπλε προς μωβ. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται σε διάφορες κλίμακες ο αισθητήρας που χρησιμοποιήσαμε:



 $Σ_{\chi \eta \mu \alpha} 3.10$ (Silicon Photomultipliers (SiPM), n.d.) [20]

3.2.4.1 Breakdown Voltage & Over-Voltage

Η τάση κατωφλίου V_{br} (*Breakdown Voltage*) είναι το σημείο όπου η ένταση του παραγόμενου ηλεκτρικού στη περιοχή απογύμνωσης είναι επαρκής για να ξεκινήσει μια αποφόρτιση *Geiger*. Το σημείο κατωφλίου φαίνεται ξεκάθαρα στο σχήμα 3.11 όπου αυξάνεται απότομα το ρεύμα.



Σχήμα 3.11 Dark Curent συναρτήσει της τάσης για SiPM 1mm με διάφορα μεγέθη μικροκυψελών (20μm, 35μm, 50μm, 100μm) [19]

Για ομαλή λειτουργία προτείνεται $V_{\text{bias}} = 2V \pi \acute{a} v \omega \alpha \pi \acute{o}$ τη τάση breakdown για συσκευές της SensL [19]. Τα 2V αναφέρονται και ως 'over-voltage' (ΔV) και είναι καθοριστική τιμή για τον ορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών που ακολουθούν.

3.2.4.2 Κέφδος

Κάθε μικοοκυψέλη σε έναν SiPM αποτελείται από μια φωτοδίοδο Geiger-mode συνδεδεμένη σε σειρά με μία ενσωματωμένη αντίσταση απόσβεσης. Κάθε μικοοκυψέλη παράγει ένα ομοιόμορφο και κβαντισμένο φορτίο όποτε υπάγεται σε Geiger breakdown. Το κέρδος κάθε μικροκυψέλης και άρα ολόκληρης της διάταξης του ανιχνευτή, ορίζεται από το λόγο του φορτίου εξόδου προς το φορτίο ενός ηλεκτρονίου. Το φορτίο εξόδου μπορεί να υπολογιστεί από την υπέρταση και τη χωρητικότητα της κάθε μικροκυψέλης όπως φαίνεται από τη παρακάτω σχέση:

$$G = \frac{C \cdot \Delta V}{q} \qquad \varepsilon \xi. \, 3.1$$

Λόγω του μοναδικού τρόπου λειτουργίας του SiPM, κάθε φωτόνιο που εντοπίζεται, παράγει ένα κβαντοποιημένο παλμό όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.9.



Για διάφορες τιμές over-voltage προκύπτει το παρακάτω γράφημα:

Σχήμα 3.12 Κέρδος συναρτήσει του Over Voltage για διάφορα μεγέθη μικροκυψελών (20μm, 35μm, 50μm, 100μm) [19]

3.2.4.3 Αποδοτικότητα Ανίχνευσης Φωτονίων (ΑΑΦ - Photo Detection Efficiency)

Η αποδοτικότητα ανίχνευσης φωτονίων ενός SiPM είναι η στατιστική πιθανότητα ενός προσπίπτοντος φωτονίου να παράξει παλμό Geiger σε μια μικροκυψέλη του SiPM. Η ΑΑΦ είναι μια συνάρτηση του μήκους κύματος και της πόλωσης και υπολογίζεται από τη παρακάτω σχέση:

$$PDE(\lambda, V) = \eta(\lambda) \cdot \varepsilon(V) \cdot F \qquad \varepsilon \xi. 3.2$$

Όπου:

 \rightarrow η(λ) είναι η κβαντική αποδοτικότητα του πυριτίου.

- → ε(V) η πιθανότητα εκκίνησης χιονοστιβάδας, η οποία λαμβάνει υπόψη ότι δεν θα εκκινήσουν χιονοστιβάδα όλα τα παραγόμενα φωτοηλεκτρόνια της διάταξης.
- → F Fill factor της διάταξης. Δηλαδή, η αναλογία ενεργούς και μη περιοχής του SiPM μιας και ανάμεσα στις μικροκυψέλες υπάρχουν κενά.

Η ΑΑΦ υπολογίζεται από την Αποκοισιμότητα (*Responsivity - R*) του ανιχνευτή, η οποία ορίζεται από το μέσο όρο παραγωγής ροής φωτονίων (*Photocurrent*) ανά μονάδα οπτικής ισχύος και υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:

$$R = \frac{I_p}{P_{op}} \qquad \varepsilon \xi. \ 3.3$$

Όπου:

- \rightarrow *I_p* Η ροή φωτονίων
- → I_{op} Η προσπίπτουσα οπτική ισχύς σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος στην επιφάνεια του ανιχνευτή

Η Αποκρισιμότητα (R) εκφράζεται σε μονάδες Ampere ανά Watt (A/W).

Αφού έχουμε την τιμή της Αποκοισιμότητας (**R**) έπειτα μπορούμε να υπολογίσουμε το ΑΑΦ (*PDE*) από τη παρακάτω σχέση:

$$PDE = \frac{R}{G} \cdot \frac{h \cdot c}{\lambda \cdot e} \qquad \varepsilon \xi. \ 3.4$$

Όπου:

- → G: είναι το κέρδος της κάθε μικροκυψέλης
- \rightarrow h: η σταθερά του Planck
- → c: η ταχύτητα του φωτός
- \rightarrow λ: το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας
- → e: το ηλεκτρικό φορτίο

Στο παρακάτω Σχήμα 3.13 φαίνεται η ΑΑΦ ενός SiPM για διάφορα μεγέθη μικροκυψελών



Σχήμα 3.13 ΑΑΦ συναρτήσει του μήκους κύματος για SiPM με διάφορα μεγέθη μικροκυψελών (20μm, 35μm, 50μm, 100μm) [19]

3.2.4.4 Θόρυβος

Ο θόρυβος, είναι ένας γενικός όρος που εκφράζει όλες τις πηγές ανεπιθύμητων σημάτων μέσα στο σύστημά μας και εμφανίζεται σε υπέρθεση πάνω στο σήμα μας. Ουσιαστικά, εξαιτίας του θορύβου περιοριζόμαστε στη μέτρηση μικρών σημάτων.

Η κυφιότεφη πηγή θοφύβου σε έναν SiPM είναι το Dark Count Rate (DCR), το οποίο οφείλεται κυφίως σε ηλεκτφόνια που εμφανίζονται λόγω θεφμότητας και και με τη σειφά τους δημιουφγούν δικές τους χιονοστιβάδες στο πεδίο υψηλής ενέφγειας. Τα σήματα που λαμβάνουμε λόγω της διάσπασης μιας κυψέλης εξαιτίας φωτοηλεκτφονίων, είτε ηλεκτφονίων παφαγόμενα από θεφμότητα, είναι ίδια. Μιας και ο θόφυβος αποτελείται από μία σειφά παλμών, η κλίμακά τους μποφεί να οφιστεί και ο φυθμός τους να πεφιγφαφεί σε KHz ή MHz. Τέλος, ποέπει να σημειωθεί, πως εάν η πηγή θοούβου ήταν σταθεοά συνεχής θα μπορούσε να υπολογιστεί και να αφαιοεθεί από το τελικό σήμα. Ωστόσο, οι διακυμάνσεις του θοούβου είναι αυτές που υποβαθμίζουν τη ποιότητα του σήματος και των μετοήσεων. Η εμφάνιση των σκοτεινών παλμών ακολουθεί κατανομή *Poisson* στο χοόνο.

3.2.4.5 Οπτική διεπαφή

Ένα επιπλέον χαφακτηφιστικό του θοφύβου ενός SiPM είναι η οπτική διεπαφή μεταξύ των μικφοκυψελών. Κατά τη διάφκεια μιας χιονοστιβάδας, φοφείς κοντά στη διεπαφή εκπέμπουν φωτόνια καθώς επιταχύνονται από το έντονο ηλεκτφικό πεδίο. Αυτά τα φωτόνια συνήθως εκπέμπουν στην υπέφυθφη πεφιοχή και μποφούν να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις εντός της συσκευής. Συνήθως εκπέμπονται πεφίπου 2x10⁵ φωτόνια ανά ηλεκτφόνιο που διασχίζει τη διεπαφή. Αυτά τα εκπεμπόμενα φωτόνια μποφούν να ταξιδέψουν σε γειτονικές μικφοκυψέλες και με τη σειφά τους να εκκινήσουν νέες χιονοστιβάδες Geiger. Η διαδικασία αυτή γίνεται σχεδόν στιγμιαία και έχει ως αποτέλεσμα μεμονωμένα φωτόνια να παφάγουν σήματα αντίστοιχα με αυτά 2, 3 ή μεγαλύτεφων φωτοηλεκτφικών γεγονότων. Το παφαπάνω γεγονός μποφεί να διακφιθεί από το σχήμα 3.14 παφακάτω, όπου ο δεύτεφος (από τα αφιστεφά) παλμός, έχει ύψος αντίστοιχο με ένα γεγονός 2 φωτονίων.



Σχήμα 3.14 Στιγμιότυπο παλμογράφου όπου φαίνονται τα dark counts. (ON Semiconductor Is Now, n.d.) [21]

3.2.4.6 Δυναμικό Εύgος και Γραμμικότητα

Το Δυναμικό Εύφος ενός ανιχνευτή οφίζεται ως το εύφος του σήματος εξόδου που βγάζει ο ανιχνευτής και είναι αξιοποιήσιμο. Για τον SiPM, αυτό το εύφος εκτείνεται από το μικφότεφο ανιχνεύσιμο σήμα μέχφι το σήμα που πφοκαλείται από την ταυτόχφονη ανίχνευση φωτονίων, απ' όλες τις μικφοκυψέλες της διάταξης. Σε αυτό το σημείο επέφχεται κοφεσμός στο σήμα μιας και δεν υπάφχουν άλλες μικφοκυψέλες να εντοπίσουν νέα φωτόνια, εκτός από αυτές που έχουν επαναφεφθεί στην αφχική φοφτισμένη τους κατάσταση και μποφούν να εντοπίσουν φωτόνια εκ νέου.

Επομένως, το Δυναμικό Εύφος ενός SiPM είναι μια συνάφτηση του συνολικού αφιθμού μικφοκυψελών και της ΑΑΦ (PDE) της συσκευής. Μιας και το PDE ενος SiPM είναι συνάφτηση της τάσης πόλωσης και του μήκους κύματος των πφοσπίπτοντων φωτονίων, το δυναμικό εύφος του SiPM θα εξαφτάται και αυτό από τις παφαπάνω παφαμέτφους. Το πλήθος των μικφοκυψελών που ενεφγοποιούνται, συναφτήσει των πφοσπίπτοντων φωτονίων, μποφεί να πφοσεγγιστεί με τη παφακάτω σχέση:

$$N_{fired}(M, V, \lambda) = M \left(1 - exp \left(-\frac{PDE(V, \lambda) \cdot N_{ph}}{M} \right) \right) \qquad \varepsilon \xi. \ 3.5$$

Όπου:

- → N_{fired} το πλήθος των μικροκυψελών που έχουν ενεργοποιηθεί
- $\rightarrow N_{vh}$ το πλήθος των προσπιπτόντων φωτονίων
- → Μ το συνολικό πλήθος των μικροκυψελών της διάταξης SiPM
- → PDE αποδοτικότητα ανίχνευσης φωτονίων όπως αναλύθηκε στο 3.2.4.3

Η σχέση 3.5 προϋποθέτει πως τα εισερχόμενα φωτόνια είναι ισομερώς κατανεμημένα στην επιφάνεια του SiPM.

Σε χαμηλά επίπεδα σημάτων, το φεύμα του SiPM είναι ανάλογο της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, δίνοντας μια γραμμική απόκριση. Όσο η

ακτινοβολία αυξάνεται, το φεύμα του SiPM αφχίζει να παφεκκλίνει από τη γφαμμικότητα εξαιτίας του πεφιοφισμένου πλήθους μικφοκυψελών και τελικά επέφχεται κοφεσμός. Το σχήμα 3.15 παφακάτω, δείχνει μια πφοσομοίωση της απόκφισης για 3600 και 1000 μικφοκυψέλες ενός SiPM όταν φωτίζεται ομοιόμοφφα από παλμούς φωτός διάφκειας 50ns σε κλιμακωτή ένταση.



Σχήμα 3.15 Γραμμικότητα για SiPMs με 3600 και 1000 μικροκυψέλες (microcells) [21]

3.2.4.7 Σχήμα Παλμού

Ένας συνηθισμένος φωτοηλεκτοικός παλμός για ένα SiPM με επιφάνεια 35mm με μέγεθος μικοοκυψέλης 35μm έχει την εξής μορφή:



Σχήμα 3.16 Παλμός SiPM 3mm και 35μm μικροκυψέλη [21]

Ο χρόνος ανόδου του παλμού του SiPM εξαρτάται από τη συνολική επιφάνεια της συσκευής και συγκεκριμένα της χωρητικότητας λόγω των γραμμών που συνδέουν όλες τις μικροκυψέλες. Ο χρόνος ανόδου κυμαίνεται από 1ns για 1mm συσκευή μέχρι ~10ns για 6mm συσκευές.

Ο χρόνος επαναφοράς ή χρόνος εξασθένησης του παλμού είναι ανεξάρτητος του μεγέθους του ανιχνευτή, αλλά, εξαρτάται από το χρόνο επαναφοράς (**τ**_{reset}) της εκάστοτε μικροκυψέλης, ο οποίος δίδεται από την παρακάτω σχέση:

$$\mathbf{\tau}_{reset} = R_Q \cdot C$$
 $\varepsilon \xi. 3.6$

Όπου:

- → C είναι η χωρητικότητα της μικροκυψέλης
- \rightarrow R_Q η τιμή της αντίστασης απόσβεσης (Quench Resistor)

Μιας και η χωρητικότητα της μικροκυψέλης εξαρτάται από την επιφάνεια, ο χρόνος επαναφοράς κυμαίνεται ανάλογα με τα διάφορα μεγέθη των μικροκυψελών.

3.2.4.8 Θεομική Εξάοτηση

Οι βασικές επιπτώσεις της θεομότητας στον SiPM είναι η αλλαγή στο breakdown voltage της διόδου και του Dark Count Rate (αναλύθηκε παραπάνω στο <u>3.2.4.4</u>)

To breakdown voltage μεταβάλλεται συναφτήσει της θεφμότητας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.17, εκτός και αν χφησιμοποιηθούν μέθοδοι αντιστάθμισης της θεφμοκφασίας.



Σχήμα 3.17 Breakdown Voltage συναρτήσει της θερμοκρασίας [21]

Μιας και η θεομική μάζα του SiPM είναι πολύ μικοή (ο ανιχνευτής έχει πάχος μόλις 500μm), είναι απλή διαδικασία να ουθμιστεί η θεομοκοασία του μέσω μιας συσκευής Peltier ενδεχομένως. Μια αύξηση της θεομοκοασίας θα επιφέοει και αύξηση των Dark Rate. Συγκεκοιμένα, για κάθε 10°C μείωση στη θεομοκοασία της συσκευής υπάοχει 50% μείωση του Dark Count Rate. Επομένως,

ένας SiPM που ψύχεται με θεφμοηλεκτοικές ψύκτοες (*Peltier*), μπορεί να ανιχνεύσει σήματα ελάχιστης έντασης φωτός με πολύ χαμηλά επίπεδα θοούβου.

Κεφάλαιο 4

Κατασκευή οργάνου

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα βήματα κατασκευής του οργάνου, από που παραγγείλαμε τα υλικά, τη τελική συναρμολόγηση, καθώς και μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων.

4.1 Συνοπτικά Βήματα κατασκευής

- Αγορά και παραγγελία όλων των εξαρτημάτων μαζί και το τυπωμένο κύκλωμα με βάση το Πίνακα 1
- Εγκατάσταση των απαραίτητων βιβλιοθηκών (libraries) στο περιβάλλον περιήγησης του Arduino
- 3. Παραλαβή, συναρμολόγηση και κόλληση εξαρτημάτων στην πλακέτα
- Τροφοδότηση του ανιχνευτή μέσω του Arduino Nano για να βεβαιωθούμε ότι το DC-DC Booster ενισχύει σωστά τη τάση
- Προσεκτικό άνοιγμα τεσσάρων εσοχών, για να κουμπώσει η πλακέτα του φωτοπολλαπλασιαστή και γυάλισμα
- 6. Τύλιγμα του σπινθηριστή με αλουμινόχαρτο
- Προσαρμογή βαζελίνης στη πλακέτα του SiPM και βιδώμα στη πλακέτα του φωτοπολλαπλασιαστή
- Τύλιγμα της πλακέτας του SiPM με μαύρη ηλεκτρική ταινία ώστε να μην υπάρχουν διαρροές φωτός
- Σύνδεση του SiPM στη κεντοική πλακέτα και βεβαίωση ορθής λειτουργίας της οθόνης OLED και βεβαίωση λειτουργίας του LED, όποτε ένα μιόνιο ενεργοποιεί τον ανιχνευτή
- 10. "Βάπτισμα" του ανιχνευτή μας φορτώνοντας τον κώδικα naming.ino [22]στο Arduino
- 11. Φόρτωση κώδικα OLED.ino ή το SDCard.ino στο Arduino, αναλόγως που θέλουμε να προβάλλουμε και να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα μας [22]
- 12. Αντιμετώπιση προβλημάτων

4.2 Αναλυτικά Βήματα κατασκευής

Σε αυτό το σημείο αναλύουμε τα βήματα κατασκευής του οργάνου, τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν καθώς και τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος που θα επιλέξει ο καθένας να το κατασκευάσει, θα έρθει αντιμέτωπος με τις αντίστοιχες προκλήσεις. Συγκεκριμένα, για το έτος 2021 που ξεκίνησε η κατασκευή αυτής της πλακέτας, αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα διάθεσης προϊόντων λόγω παγκόσμιας έλλειψης microchip, το λεγόμενο Chip Shortage [23].

4.2.1 Αγοράζοντας τα υλικά

Το πφώτο βήμα κατασκευής του οφγάνου ήταν να πφομηθευτούμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και υλικά. Λόγω του ότι η πλειονότητα των εξαφτημάτων πωλούνται σε μεγάλες ποσότητες, πεφίσσεψαν αφκετά υλικά, ωστόσο σε βάθος χφόνου το παφαπάνω γεγονός διευκόλυνε στη κατασκευή, μιας και υπήφχαν εναλλακτικές σε πεφιπτώσεις ατυχήματος ή δυσλειτουφγίας. Στον Πίνακα 1 έχουν συμπεφιληφθεί αναλυτικά τα καταστήματα, οι ποσότητες καθώς και το κόστος του εκάστοτε στοιχείου. Η χφωματική διαφοφοποίηση του πίνακα είναι για να διευκολύνει τη διάκφιση ανάμεσα στους διαφοφετικούς πφομηθευτές.

- Πρώτο βήμα ήταν η αποστολή των αρχείων Gerber [24] σε μια εταιρία κατασκευής PCB εκτός Ελλάδος. Συνήθως, η κατασκευή γίνεται σε τεμάχια των 5, των 10 κ.ο.κ. μιας και πρόκειται για γραμμή παραγωγής και δε συμφέρει το εργοστάσιο να παράξει μόνο ένα τεμάχιο. Οι πλακέτες που χρειάστηκαν είναι 2 επιπέδων και το πάχος τους δεν έπρεπε να ξεπερνάει το 1.6 mm ώστε να χωρέσουν άνετα μέσα στο κουτί τους. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας αγοράστηκαν 10 PCB's στη τιμή των 5.90 € και παραδόθηκαν μετά από 13 ημέρες, με μία μικρή καθυστέρηση στο τελωνείο.
- To elecrow.com μπορεί επίσης, να κόψει με λέιζερ ακρυλικές επιφάνειες
 οι οποίες θα χρειαστούν στα τελευταία στάδια του πακεταρίσματος του

οργάνου. Αξιοποιήθηκε αυτή η υπηρεσία και έγινε παραγγελία μαζί με τις πλακέτες και οι δύο επιφάνειες, σύμφωνα με τα σχέδια όπως ήταν στο github του πρότζεκτ στο φάκελο '*Enclosure_Files*' [26], οι οποίες θα τοποθετηθούν στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αλουμινένιου κουτιού, που θα περιέχει τον ανιχνευτή. Ηρθαν σε πακέτο των δέκα όπως απεικονίζονται παρακάτω.



Σχήμα 4.1 Οι ακρυλικές επιφάνειες όπως παρελήφθησαν

3. Το αλουμινένιο κουτί πακεταρίσματος του οργάνου, μπορεί να σχεδιαστεί σε εκτυπωτή 3D ή να αγοραστεί από κάποιο κατάστημα με ηλεκτρονικά που διαθέτει έτοιμα κουτιά, συνήθως από πλαστικό. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας έγινε παραγγελία από κατάστημα του εξωτερικού με επιλεγμένο μήκος τις 2.9 ίντσες και ακολουθήθηκε το <u>Σχέδιο 2</u> του παραρτήματος.



Σχήμα 4.2 Δείγμα του αλουμινένιου κουτιού που χρησιμοποιήθηκε για το πακετάρισμα του οργάνου

- Τα ηλεκτφονικά στοιχεία (αντιστάσεις, πυκνωτές, δίοδοι και ολοκληφωμένα κυκλώματα) αγοφάστηκαν από διεθνή εμποφικά ηλεκτφονικά καταστήματα, όπως το Amazon [30] και ebay [33]. Παφουσιάζονται αναλυτικά στο Πίνακα 1 του παφαφτήματος.
- 5. Το Arduino Nano των 16 MHz, μπορεί να βρεθεί σε πολλά καταστήματα χόμπι και ηλεκτρονικών. Για την οθόνη OLED, χρειάστηκε προσοχή καθώς, η πλειοψηφία των Ελληνικών καταστημάτων με ηλεκτρονικα διαθέτουν αντίστοιχες οθόνες με ανεστραμμένα τα pins για VCC & GND. Η οθόνη που χρησιμοποιήθηκε για τη κατασκευή, χρειάζεται να έχει το VCC στην 4η θέση, προς την εξωτερική πλευρά, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.3.



Σχήμα 4.3 Οθόνη OLED που χρησιμοποιήθηκε με το VCC να είναι στη 4η θέση (κάτω)

- 6. Ο φωτοπολλαπλασιαστής (SiPM) το οποίο είναι και το πιο κοστοβόρο στοιχείο με κόστος 79,75 €, απαιτεί και το πιο προσεκτικό χειρισμό κατά τη κόλληση. Στο πλαίσιο της κατασκευής του οργάνου επιλέξαμε το SensL 60035 SMT C-series [19], το οποίο έχει διαστάσεις 6mm x 6mm άρα 36mm² ενεργό περιοχή.
- 7. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που διαθέτουν σπινθηριστές, ωστόσο μπορούν να βρεθούν και από εργαστήρια φυσικής, που τα έχουν χρησιμοποιήσει για πειράματα στο παρελθόν. Για τη δική μας διάταξη χρησιμοποιήσαμε έναν σπινθηριστή BC-408 πάχους 1 cm όπως αναλύθηκε στο <u>3.1.3</u>, μιας και είναι ο πιο κοινότυπος και ιδανικός για τους σκοπούς της παρούσας διπλωματικής εργασίας και θα παράξει ικανοποιητικό αριθμό φωτονίων. Η ανίχνευση φωτονίων του φωτοπολλαπλασιαστή που χρησιμοποιήσαμε έχει υψηλότερη απόδοση στα 420 nm, επομένως, μπορεί να επιλεγεί σπινθηριστής που να εκπέμπει κοντά σε αυτό το μήκος κύματος. Για το συγκεκριμένο όργανο βρήκαμε τον σπινθηριστή μέσα από το ebay.com [33].

4.2.2 Εισαγωγή του κώδικα στο Arduino

Αφού αγοράσαμε τα υλικά, προχωρήσαμε στη προετοιμασία του περιβάλλοντος προγραμματισμού του Arduino. Αρχικά εγκαταστήσαμε το ενσωματωμένο περιβάλλον περιήγησης (IDE) του Arduino στο λειτουργικό μας σύστημα [35], το οποίο είναι ένα περιβάλλον στο οποίο ανοίξαμε και δουλέψαμε τον κώδικα μας.

Προηγήθηκε έλεγχος του κώδικα του Arduino, ότι δουλεύει σωστά. Μόλις αγοράστηκε, προχωρήσαμε σε κολλήσεις στην πλακέτα. Αυτό το βήμα θέλει προσοχή, καθώς εάν το Arduino εμφανίσει προβλήματα, ενώ είναι κολλημένο στη κεντρική πλακέτα είναι πολύ δύσκολο, έως και απίθανο να αφαιρεθεί. Για λειτουργία σε περιβάλλον Mac, χρειάστηκε να εγκαταστήσουμε και το πρόγραμμα οδήγησης - driver CH340g [36] για να αναγνωρίζει το λειτουργικό μας σύστημα το Arduino Nano από τις θύρες USB.

Αφού εκκινήσαμε το Arduino IDE έπρεπε να εγκαταστήσουμε και ορισμένες βιβλιοθήκες ώστε να δουλέψει ο κώδικας. Οι βιβλιοθήκες εγκαταστάθηκαν πατώντας το Sketch \rightarrow Include Libraries \rightarrow Manage Libraries. Εκεί, λοιπόν, κάναμε αναζήτηση και εγκαταστίσαμε τις παρακάτω βιβλιοθήκες:

- 1. Adafruit_SSD1306 by Adafruit Version 1.0.1
- 2. Adafruit_GFX by Adafruit Version 1.0.2
- 3. TimerOne by Jesse Tane et al. Version 1.1.0
- 4. EEPROM
- 5. SD
- 6. Wide
- 7. SPI

Οι βιβλιοθήκες 4 - 7 ήταν ήδη εγκατεστημένες στο σύστημά μας.

Τέλος, επιλέξαμε από το IDE ότι χρησιμοποιούμε Arduino Nano και ενημερώσαμε το IDE σε ποια θύρα USB έχουμε συνδέσει τον μικροελεγκτή μας. Αφού, λοιπόν, συνδέσαμε το Arduino Nano, πήγαμε στο Tool \rightarrow Board \rightarrow Arduino Nano και μετά επιλέξαμε το USB Port από το Tool \rightarrow Port.

Όταν τρέξαμε το Arduino Nano για πρώτη φορά έπρεπε να το "βαφτίσουμε" και αυτό έγινε τρέχοντας το κώδικα naming.ino [22]. Ανοίξαμε το αρχείο, πατήσαμε το πράσινο "check", στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, ο κώδικας έκανε compile χωρίς λάθη και έπειτα πατήσαμε το βελάκι που δείχνει προς τα πάνω και φορτώσαμε το κώδικα στο Arduino Nano. Στη συνέχεια, επιλέξαμε αν θέλουμε η έξοδος των δεδομένων να γίνεται από την οθόνη OLED ή να γράφονται σε .txt αρχείο σε κάρτα microSD. Αναλόγως το στόχο μας κάθε φορά φορτώναμε και το αντίστοιχο πρόγραμμα, OLED.ino ή SDCard.ino [22].

Το κάθε πρόγραμμα θεωρείται μεγάλο για τα δεδομένα του Arduino Nano, μιας και καταλαμβάνει περίπου το 70% της χωρητικότητας του και 60% της διαθέσιμης SRAM. Επομένως, αναλόγως τη λειτουργία του οργάνου και των συνθηκών, πρέπει να επιλέξουμε κάθε φορά πως θέλουμε να διαβάζουμε την έξοδο του οργάνου.

Ο χρόνος φόρτωσης του προγράμματος διαρκεί συνήθως ~30 δευτερόλεπτα.

4.2.3 Κατασκευάζοντας την πλακέτα

Όταν παφαλάβαμε τη πλακέτα από το εφγοστάσιο παφαγωγής PCB ήταν όπως απεικονίζεται παφακάτω:



Σχήμα 4.4 Οι πλακέτες όπως παρελήφθησαν από το κατάστημα παραγωγής PCB

Αποτελείται από τοια μέοη, τη βασική πλακέτα, το κύκλωμα του SiPM και το κύκλωμα της κάοτας SD τα οποία συναομολογήθηκαν σε μετέπειτα στάδιο. Κάθε μέοος έχει σχεδιαστεί, χοησιμοποιώντας τεχνολογία "0805 Surface Mount Technology (SMT)" στοιχεία, γεγονός που σημαίνει πως όλα μας τα εξαοτήματα έχουν μέγεθος 0.08 ίντσες x 0.05 ίντσες. Είναι αρκετά μικροσκοπικά, ωστόσο με κατάλληλη εξάσκηση, εργαλεία και προσοχή, ήταν διαχειρίσιμα.

Για τις κολλήσεις χρειάστηκε να εκτυπώσουμε τον <u>Πίνακα 2</u> από το παράρτημα και ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως πίνακας αναφοράς καθ'όλη τη διάρκεια των

κολλήσεων. Λόγω του πλήθους και του μικρού μεγέθους των στοιχείων, χωρίς κατάλληλη οργάνωση, το λάθος θα ήταν αναπόφευκτο. Στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται αναλυτικά το κάθε στοιχείο που τοποθετείται στην πλακέτα και με κατάλληλη χρωματική κωδικοποίηση.

4.2.3.1 Η Κεντρική Πλακέτα

Η κεντοική και μεγαλύτεοη σε μέγεθος πλακέτα, είναι αυτή που διαχειοίζεται τα δεδομένα μας. Σχεδιάστηκε με σκοπό τα Surface Mount Devices (SMD's) όπως οι πυκνωτές και οι αντιστάσεις να βοίσκονται στο κάτω μέοος, ενώ τα μεγαλύτεοα στοιχεία στο πάνω.

Η κεφαλή με τα 6 pins, χοησιμοποιείται για να ενωθεί η πλακέτα του SiPM με τη κεντοική. Το κουμπί με το reset χοησιμοποιείται για να επανεκκινήσει τον κώδικα του Arduino Nano. Από τα μεγάλα σε μέγεθος στοιχεία είναι LED, όπου απαιτείται ποοσοχή στο πως θα τοποθετηθεί, καθώς έχει συγκεκοιμένη φορά. Ποος το τέλος, τοποθετήσαμε την οθόνη OLED μαζί με το 4-pin 3.5mm θηλυκό audio connection και τη σύνδεση του BNC Connector. Το BNC συνδέεται απευθείας με την έξοδο του SiPM. Έτσι, μποορεί να συνδεθεί απευθείας με έναν παλμογράφο και να δούμε τους παλμούς εξόδου του SiPM χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία.

Το τελευταίο στοιχείο που ποοσθέσαμε στη κεντοική πλακέτα είναι το Arduino Nano. Ποιν τοποθετήσουμε όμως τον μικοοελεγκτή έποεπε να κολλήσουμε τα 1x16 και 1x14 pin headers, όπου τα μακοιά ποδαράκια εισέρχονταν στη κεντοική πλακέτα. Παράλληλα, έποεπε να επιβεβαιώσουμε πως τα 8 pins (2x4) που θα τοποθετηθεί η πλακέτα της κάρτας microSD είναι τοποθετημένα σωστά. Η κάτω όψη της κεντοικής πλακέτας με όλα τα στοιχεία τοποθετημένα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Σχήμα 4.5 Η κάτω όψη της κεντρικής πλακέτας

Αφού ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση στοιχείων στη κεντρική πλακέτα αρχίσαμε τις δοκιμές στη τροφοδοσία του SiPM. Τροφοδοτήσαμε τη κεντρική πλακέτα συνδέοντάς την με το Mini USB του Arduino Nano στον υπολογιστή και ελέγξαμε αν η τάση ανάμεσα στο HV pin και στη γείωση, είναι +29.5V.

Στην πρώτη δοκιμή η έξοδος δεν ήταν ή αναμενόμενη, για την ακρίβεια, αντί να ανορθώνεται η τάση, έπεφτε. Καταλήξαμε στο γεγονός πως το ολοκληρωμένο LT3461 (το μικρότερο της διάταξης) είχε καεί, και αφου αντικαταστάθηκε, η ανόρθωση της τάσης γινόταν κανονικά.

Επίσης, συνδέσαμε και την οθόνη OLED η οποία όμως δεν εμφάνισε κάποιο χρήσιμο δεδομένο μιας και το κύκλωμα του SiPM δεν ήταν συνδεδεμένο. Χωρίς το κύκλωμα του SiPM συνδεδεμένο το pin0 (A0) του Arduino Nano διαβάζει στατικό σήμα.

4.2.3.2 Πλακέτα του SiPM

Αφού τελειώσαμε με τη βασική πλακέτα, προχωρήσαμε στη τοποθέτηση των στοιχείων στην πλακέτα του φωτοπολλαπλασιαστή ή αλλιώς του SiPM. Είναι το κύκλωμα που απαιτεί και την περισσότερη προσοχή, καθώς ο αισθητήρας αυτός είναι ο πιο ακριβός του οργάνου.

Η αντίσταση που τοποθετείται στην άνοδο του SiPM, τοποθετείται για να κρατάει τη γραμμή στη γείωση για όσο δεν υπάρχει σήμα από το SiPM. Η αντίσταση με αυτή τη λειτουργία, ονομάζεται και *Pull down resistor*. Οι υπόλοιπες αντιστάσεις και οι πυκνωτές που τοποθετούνται, χρησιμοποιούνται για να φιλτράρουν τη τάση πόλωσης του SiPM. Στην ίδια πλευρά υπάρχει και ένας κονέκτορας με 6 pins και 2 αλουμινένιες υποδοχές για να ενωθεί με τη βασική πλακέτα.

Το πάνω μέφος της πλακέτας πεφιέχει τον αισθητήφα μας ο οποίος διαθέτει ανακλαστικό υλικό, μιας και οι πλακέτες δεν είναι οπτικά σφφαγισμένες όπως έχει αναλυθεί στο <u>3.1.3</u>.

Παρακάτω φαίνεται ολοκληρωμένη η πλακέτα του SiPM (κάτω όψη).



Σχήμα 4.6 Κάτω όψη της πλακέτας του SiPM

4.2.3.3 Πλακέτα της κάφτας microSD

Η μικρότερη σε μέγεθος πλακέτα είναι αυτή της κάρτας microSD. Ο λόγος ύπαρξης της, είναι για να μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα καταγραφής οπουδήποτε, χωρίς τη δέσμευση της σύνδεσης με το διαδίκτυο, ή την ύπαρξη κάποιου υπολογιστή. Αυτή η πλακέτα περιέχει την υποδοχή της κάρτας microSD, έναν 3,3 V ρυθμιστή τάσης και έναν μεταφραστή λογικού επιπέδου που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της κάρτας microSD στα 3,3 V. Ο λόγος που δεν αξιοποιούμε τα 3,3 V του Arduino Nano, είναι διότι οι κάρτες microSD μπορούν να τραβήξουν μέγιστο ρεύμα έως και 200mA σε peak load, ενώ το Arduino Nano έχει μέγιστο στα 150mA [37].

Το ολοκληφωμένο (logic level translator) ήθελε ιδιαίτεφη πφοσοχή στη τοποθέτηση μιας και έχει κατεύθυνση και μικφά ποδαφάκια. Το μικφό κυκλάκι στην επιφάνεια βοηθάει στη κατεύθυνση. Στο παφακάτω σχήμα φαίνονται οι 2 όψεις.



Σχήμα 4.7 Στην (α) διακρίνεται η κάτω όψη της πλακέτας του microSD ενώ είναι ακόμα ενωμένη με τη κεντρική πλακέτα για διευκόλυνση στις κολλήσεις. Στη (β) βλέπουμε τη πάνω όψη της πλακέτας ένω έχει συνδεθεί με τη κεντρική πλακέτα

4.2.4 Προσαρμογή του πλαστικού σπινθηριστή

Όσο καλύτερα γυαλισμένος είναι ο σπινθηριστής τόσο θα αυξηθεί και ο ρυθμός συλλογής φωτονίων από τον αισθητήρα μας, μιας και η οπτική διαπερατότητα θα αυξηθεί. Αφού τον τυλίξαμε με ανακλαστική επιφάνεια, εμείς διαλέξαμε λίγο πιο παχύ αλουμινόχαρτο που μπορεί να βρεθεί σε οποιοδήποτε σουπερμάρκετ, προσθέσαμε και βαζελίνη στις επιφάνειες, ώστε να ταιριάξει ο δείκτης διάθλασης του σπινθηριστή και της ανακλαστικής επιφάνειας γύρω από το SiPM και να μεγιστοποιηθεί η απόδοσή μας, όπως αναλύθηκε στο <u>3.1.3</u>.

Στο Παφάφτημα, φαίνεται <u>σχέδιο CAD</u> που ακολουθήθηκε για να τοποθετηθούν οι εσοχές. Η δημιουφγία των εσοχών γίνεται για να τοποθετηθούν οι βίδες. Η διαδικασία απαιτούσε πολύ πφοσοχή και λεπτό χειφισμό για να μη φαγίσει ο σπινθηφιστής.

Γι'αυτό χρησιμοποιήσαμε πολύ χαμηλά RPM's. Συγκεκριμένα, βάλαμε το μύλο στα 60 rpm σε κρουστική κίνηση για να κάνουμε 4 τρύπες που σχηματίζουν ένα τετράγωνο 3 x 3 cm. Το τρυπάνι ήταν νούμερο 54 (1,397mm), που έκανε αρκετά μεγάλες τρύπες για βίδες τύπου 5/16" Number 0 οι οποίες μποφούν να κουμπώσουν αυτόματα. Αν παφαγόταν αφκετή θεφμότητα κατά τη δημιουφγία των εσοχών θα μποφούσε να είχε φαγίσει ο σπινθηφιστής μας. Καλή πφακτική ήταν η αφαίφεση των θφαυσμάτων με κάποιο φυσητήφι ώστε να μη πφοκαλείτο επιπλέον φθοφά στο υλικό μας.



Σχήμα 4.8 Δημιουργία εσοχών

Τοποθετήσαμε ταινία *Kapton* [38] για να μειωθεί η πιθανότητα *φαγίσματος* του υλικού.

Αφού ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του σπινθηριστή, γυαλίστηκε με θερμότητα, ώστε να αυξηθεί η οπτική διαπερατότητα των επιφανειών του χρησιμοποιώντας Πιστόλι Θερμού Αέρα του εργαστηρίου. Ρυθμίστηκε στη χαμηλότερη ροή αέρα στους 450 °C. Με αυτή τη διαδικασία το πλαστικό έλιωνε στην επιφάνεια και όταν κρύωσε ήταν μια συμπαγής οπτικά διαφανής επιφάνεια. Ήθελε επιπλέον προσοχή και εδώ μιας και η υπερθέρμανση μπορούσε να λιώσει το υλικό μας και να δημιουργούσε εσωτερικές παραμορφώσεις με μη αναστρέψιμες συνέπειες. Η θέρμανση και λείανση ήταν το τελευταίο βήμα επεξεργασίας του σπινθηριστή πριν τοποθετηθεί στην πλακέτα.



Σχήμα 4.9 Πιστόλι Θερμού Αέρα

4.2.5 Συνδέοντας τον πλαστικό σπινθηριστή με την πλακέτα του SiPM

Επόμενο βήμα ήταν να καλυφθεί ο σπινθηριστής με αλουμινόχαρτο και μονωτική ταινία, όπως φαίνεται στη φωτογραφία παρακάτω:



Σχήμα 4.10 Ο σπινθηριστής τυλιγμένος με αλουμινόχαρτο και μαύρη μονωτική ταινία

Έπρεπε να μείνει κενή μια τετράγωνη επιφάνεια 2 x 2 cm που θα βλέπει το SiPM. Έπειτα, έπρεπε να σταθεροποιηθεί το αλουμινόχαρτο με μονωτική

ταινία η οποία έπφεπε να τοποθετηθεί με πφοσοχή χωφίς να τεντωθεί ιδιαίτεφα (γιατί με το καιφό θα χαλαφώσει). Οι τφύπες στη μονωτική ταινία που οδηγούν στις βίδες έγιναν από πφιν και έτσι τις εντοπίστηκαν εύκολα κατά τη διάφκεια σύνδεσης με τη κεντφική πλακέτα. Έπειτα τοποθετήθηκε βαζελίνη με πφοσοχή στην επιφάνεια του SiPM και κούμπωσε ο σπινθηφιστής από πάνω.

Η πλακέτα του SiPM τοποθετήθηκε πάνω στον σπινθηριστή βιδώνοντας τέσσερις 5/16" Νο. 0 βίδες. Δε χρειάστηκε να βιδωθούν με πολύ δύναμη για να μην υποστεί ζημιά ο αισθητήρας μας. Αφήσαμε 0.5 - 1 mm χώρο ανάμεσα στη πλακέτα του SiPM και στον σπινθηριστή. Αφού τοποθετήθηκε σταθερά ο σπινθηριστής, τυλίχτηκε όλη η διάταξη με μονωτική μαύρη ταινία ώστε να σφραγιστεί οπτικά. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Σχήμα 4.11 Η τελική μορφή του σπινθηριστή αφού έχει τυλιχτεί με μαύρη μονωτική ταινία και είναι έτοιμος να κουμπώσει στην κεντρική πλακέτα

4.2.6 Τελική συναρμολόγηση όλων των στοιχείων

Αφού συνδέθηκε η πλακέτα του SiPM με την κεντοική πλακέτα μέσω του 6-pin connector βεβαιωθήκαμε ότι η τάση σε κάθε σημείο είναι σωστή.

Συγκεκοιμένα ο 6-pin connector χοησιμοποιείται για να τοοφοδοτεί τη πολωμένη τάση από τη κεντοική πλακέτα στην πλακέτα του SiPM και ταυτόχοονα να μεταφέρει το σήμα από το SiPM πίσω στη κεντοική πλακέτα.

Τα pins που έχουν τάση +29.5 V δηλώνονται ως "ΗV". Παραδίπλα μπορούμε να δούμε και τη γείωση "GND" καθώς και τα pins με το σήμα "SGN". Κάθε σύνδεση διαθέτει 2 pins για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση που χαλάσει ένα εκ των δυο, πάλι δουλεύει κανονικά η διάταξή μας. Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.12 παρακάτω:



Σχήμα 4.12 Κοντινή όψη του 6 pin connector

Ελέγξαμε τη τάση πόλωσης συνδέοντας ένα πολύμετοο ανάμεσα στο pin για το ΗV και σε αυτό του GND. Η ένδειξη που διαβάσαμε ήταν στα + 29.5 V. Γεγονός που σημαίνει πως το κύκλωμα λειτουργεί.

Αφού επιβεβαιώσαμε την οφθή λειτουφγία του κυκλώματος και τις ενδείξεις των τάσεων πφοχωφήσαμε στη σύνδεση της πλακέτα του SiPM με την κεντφική και τη σύνδεση όλης της διάταξης με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Αφού συνδέθηκαν, αμέσως αφχίσαμε να παφατηφούμε ενδείξεις στην οθόνη OLED, συγκεκφιμένα, φυθμούς γεγονότων στο 5.279 cps (counts per second) όπως φαίνεται στο σχήμα 4.13 παφακάτω.



Σχήμα 4.13 Πρώτο δείγμα λειτουργίας με πολύ υψηλό Count Rate

Ο ουθμός 5.2 θεωρείται πάρα πολύ υψηλός, μιας και 0.5 - 1.5 cps είναι ο συνήθης ουθμός αν βοισκόμαστε σε στάθμη θάλασσας, εκτός και εαν υπήρχε κάποιο ραδιενεργό υλικό μέσα στο εργαστήριο, γεγονός που δεν ίσχυε. είχαμε κάποια Επομένως, σήμαινε πως διαρροή φωτός και 0 φωτοπολλαπλασιαστής διάβαζε μεγάλη εισροή φωτονίων. Η πρώτη κίνηση ήταν να προσθέσουμε άλλες δύο στρώσεις μονωτικής ταινίας στον σπινθηριστή και όντως μειώθηκε ο ρυθμός. Ωστόσο, πάλι παρέμενε υψηλός για τα γεωγραφικά δεδομένα του Ε.Μ.Π όπου γινόταν η κατασκευή. Η επόμενη λύση ήταν η παρέμβαση στο κώδικα του Arduino όπου αλλάξαμε το signal_threshold από το κώδικα OLED.ino [22] σε μεγαλύτερο νούμερο, δηλαδή, πρακτικά φιλτράραμε τα χαμηλότερης έντασης σήματα που καταγράφονται.

Οι παφαπάνω διοφθωτικές διεφγασίες είχαν ως αποτέλεσμα τα cps να έφθουν σε φυσιολογικά για το πεφιβάλλον επίπεδα. Πεφαιτέφω ανάλυση για τα cps και τους παφάγοντες που τα επηφεάζουν, αναλύονται στο <u>Κεφάλαιο 6</u>.

Τελευταίο βήμα για τη προστασία του οργάνου και την εύκολη μεταφορά του, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος έκθεσης των στοιχείων είναι το πακετάρισμα. Εμείς τοποθετήσαμε τη διάταξη σε αλουμινένιο κουτί, σύμφωνα με τις διαστάσεις του <u>Σχεδίου 2</u> του παραρτήματος. Στις εμπρόσθιες και οπίσθιες όψεις χρησιμοποιήθηκε ακρυλικό υλικό μιας και έγινε μαζική παραγγελία από κατάστημα του εξωτερικού σε αρκετά χαμηλό κόστος ανά τεμάχιο.

Αποφεύχθηκε η χρήση αγώγιμου υλικού στις προσόψεις καθώς εξέχουν 4 pins από την οθόνη OLED τα οποία εάν έρχονταν σε επαφή με την επιφάνεια θα βραχυκύκλωνε. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το ολοκληρωμένο πακεταρισμένο όργανο, έτοιμο για χρήση στο πεδίο.



Σχήμα 4.14 Εμπρόσθια και οπίσθια όψη του οργάνου (από αριστερά προς τα δεξιά)



Σχήμα 4.15 Εμπρόσθια όψη με κουμπωμένο το καπάκι και σε λειτουργία

Κεφάλαιο 5

Ηλεκτρονική Λειτουργία

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύουμε τη λειτουργία του κυκλώματος μας από τη διαδικασία λήψης παλμού, τη μετατροπή του και την ανάγνωση και αποθήκευσή του. Ακολουθεί μετά η διαδικασία καλιμπραρίσματος των στοιχείων και τρόποι αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων.

5.1 Περιγραφή Κυκλώματος

Στόχος και βασική λειτουργία της κεντρικής πλακέτας είναι η ενίσχυση και διαμόρφωση του σήματος που δέχεται από το κύκλωμα του SiPM, ώστε να μπορεί να μετρηθεί από το Arduino Nano. Έπειτα, φιλτράρει και ρυθμίζει τις τάσεις που λαμβάνει από τον ανιχνευτή. Η ενίσχυση και προσαρμογή της κυματομορφής επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας δύο rail-to-rail τελεστικούς ενισχυτές (op amps) εισόδου-εξόδου.

Ο μικοοεπεξεογαστής που χρησιμοποιείται είναι το ευρέως διαδεδομένο Arduino Nano ATmega328 των 16 MHz το οποίο έχει ως έξοδο μια οθόνη OLED 0.96 ιντσών και ανεβάζει δεδομένα μέσω ενος καλωδίου USB mini όταν συνδεθεί με υπολογιστή. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα καταγραφής δεδομένων και σε συσκευή αποθήκευσης κάρτας microSD. Ο κώδικας που χρησιμοποιείται για να τρέξει το Arduino Nano βρίσκεται στο github του πρότζεκτ [22].

Στο παφάφτημα, Σχέδιο 3 μποφείτε να δείτε το πλήφες κυκλωματικό διάγφαμμα της διάταξης. Οι επιμέφους πλακέτες (Κεντφική, SiPM, microSD) χωφίζονται με το μπλε παχύ πεφίγφαμμα και τα επιμέφους κυκλώματα στις εκάστοτε πλακέτες με διακεκομμένο μπλε πεφίγφαμμα. Στις παφακάτω ενότητες θα αναλύσουμε την ακφιβή λειτουφγία του κάθε σταδίου του κυκλώματος παίφνοντας επιμέφους στιγμιότυπο του Σχεδίου 3.

5.1.1 DC-DC Booster

Το DC-DC Booster λαμβάνει τάση 4.6 V DC από τη σύνδεση USB και την ενισχύει στα +29.5 V προκειμένου να πολωθεί το SiPM.



Σχήμα 5.1 Κυκλωματικό διάγραμμα του DC-DC Booster

To DC-DC Booster υλοποιείται χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένο κύκλωμα από την εταιρία *Linear Technology* [43], συγκεκριμένα το LT3461ES6 [44].

5.1.2 Κύκλωμα SiPM



Σχήμα 5.2 Διάταξη κυκλώματος SiPM

Η διάταξη του SiPM, που βρίσκεται στο πάνω αριστερό μέρος του κυκλώματος του <u>Σχεδίου 3</u>, περιέχει αρκετούς πυκνωτές και αντιστάσεις που συνδέονται με τη κάθοδο του SiPM. Στόχος του κυκλώματος αυτού είναι να φιλτράρει τις υψηλές συχνότητες και τον θόρυβο από το σήμα μας, γνωστό και ως low-pass filter. Το pin 1 (anode) του SiPM μπορεί να εντοπιστεί παρατηρώντας ένα "ποδαράκι" να περισσεύει.


Σχήμα 5.3 Κάτοψη του αισθητήρα SiPM [19]

Τα pins 2 & 4 δεν αξιοποιούνται στη συγκεκριμένη διάταξη. Επίσης, στο pin 1 υπάρχει και μία αντίσταση 49.9 Ω (R12), αυτή η αντίσταση είναι γνωστή ως αντίσταση *pull-down* και χρησιμοποιείται για να "κρατάει" τη γραμμή στη γείωση όταν δεν υπάρχει σήμα από το SiPM.

Όταν μία μικοοκυψέλη στο εσωτερικό του SiPM αποφορτίζεται, ένα μικρό ρεύμα ρέει από το pin 3 στο pin 1, δηλαδή, από την κάθοδο στην άνοδο. Η τάξη μεγέθους αυτής της αποφόρτισης είναι μερικά millivolt. Όταν ένα μιόνιο περάσει από το πλαστικό σπινθηριστή συνήθως βλέπουμε ~10 φωτόνια. Στη σύνδεση "BNC out", που φαίνεται στο κέντρο του κυκλώματος όλης της διάταξης, μπορούμε να συνδέσουμε απευθείας έναν παλμογράφο και να παρατηρήσουμε το σήμα προερχόμενο απευθείας από το SiPM.



5.1.3 Ενίσχυση του σήματος & Ανιχνευτής Peak Detector

Σχήμα 5.4 Διάταξη κυκλώματος Ενίσχυσης

Η ενίσχυση του σήματος γίνεται στο μέσον της κεντοικής πλακέτας, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 3 του παραρτήματος. Σε αυτό το στάδιο, το κύκλωμα λαμβάνει το θετικό σήμα από το SiPM και το ενισχύει κατά 24. Η ενίσχυση των υψηλών συχνοτήτων μειώνεται με τη χρήση του πυκνωτή C7 = 10 pF και ταυτόχρονα βελτιώνουμε την απόκριση ADC.

Έπειτα, το σήμα προωθείται στο κύκλωμα του 'Peak Detector'. Σκοπός αυτού του μέρους του κυκλώματος είναι να διατηρήσει την κορυφή (peak) του ενισχυμένου παλμού για επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να προλάβει να το "διαβάσει" το Arduino, έπειτα το αφήνει και περιμένει τον επόμενο παλμό.

Μόλις περάσει ο ενισχυμένος παλμός στο κύκλωμα, προχωράει στην είσοδο του μη αναστρέφοντος τελεστικού ενισχυτή και η δίοδος Schottky (D1)

πολώνεται ορθά, και έτσι επιτρέπει στον τελεστικό ενισχυτή να φορτίσει τον πυκνωτή δειγματοληψίας C6. Καθώς φορτίζεται ο πυκνωτής, αναπόφευκτα, υπάρχουν διαρροές ρεύματος μέσω των αντιστάσεων R6 & R7 προς τη γείωση. Ωστόσο, αυτές οι αντιστάσεις επίτηδες έχουν επιλεγεί να είναι μεγάλες από τον σχεδιαστή ώστε οι διαρροές να είναι αμελητέες. Όταν ο παλμός του ενισχυμένου σήματος υποχωρήσει, η δίοδος D1 γίνεται ανάστροφα πολωμένη και εξαναγκάζει τον C6 να "εκφορτώσει" μέσω της αντίστασης R7. Το ρεύμα έπειτα θα κατευθυνθεί προς τη γείωση μέσω δύο διαφορετικών διαδρομών αναλόγως τη τάση του C6.

Αν η τάση από το C6 είναι μεγάλη (μεγαλύτεφη από τη πτώση τάσης στη D2) τότε η δίοδος αυτή γίνεται ορθά πολωμένη και επιτφέπει στο φεύμα να πεφάσει στην έξοδο του τελεστικού ενισχυτή. Αν η τάση στον C6 είναι μικφότεφη από την πφοωθημένη πτώση τάσης της D2, τότε η δίοδος θα είναι ανάστροφα πολωμένη και το φεύμα θα πεφάσει μέσα από τις αντιστάσεις R6 & R7 που είναι συνδεδεμένες σε σειφά. Η σταθεφά διάσπασης που σχετίζεται με αυτό είναι (R6 + R7) x C6. Αυτή η διακλάδωση βελτιώνει σημαντικά την αντίδφαση του οφγάνου σε πολύ μικφούς ή πολύ μεγάλους εισεφχόμενους παλμούς. Δεδομένου ότι R6 = R7 = 100 kΩ και με C6 = 10 nF αναμένουμε χφόνο διάσπασης πεφίπου 0.5 ms.

Η έξοδος του τελεστικού ενισχυτή μπορεί να οδηγηθεί μέχρι τα 4.6 V, εφ'όσον είναι συνδεδεμένο στο +5 V του Arduino Nano - που πρακτικά βγάζει έξοδο +4.6 V όταν τροφοδοτείται από το καλώδιο USB.

Επομένως, η πτώση τάσης στη δίοδο D1 είναι περίπου 0.4 V, και η μέγιστη έξοδος τώρα γίνεται περίπου 4.2 V. Οι δίοδοι έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να μειώσουν στο μέγιστο τη προωθημένη πτώση τάσης, ώστε να μετρήσουμε τη μέγιστη δυνατή τάση στο κύκλωμά μας.



5.1.4 microSD card & κύκλωμα

Σχήμα 5.5 Διάταξη κυκλώματος Ενίσχυσης

Το κύκλωμα της κάφτας SD πεφιέχει έναν φυθμιστή τάσης των 3.3 V, ο οποίος λαμβάνει είσοδο 4.6 V από το Arduino Nano και το μετατφέπει στα 3.3 V για να τφοφοδοτήσει την microSD κάφτα. Οι πυκνωτές που βφίσκονται εκατέφωθεν του φυθμιστή δφουν ως φίλτφα ώστε να μειώσουν το θόφυβο και να αποθηκεύσουν ενέφγεια. Τέλος, το κύκλωμα πεφιέχει έναν μη-αναστφέφων buffer ο οποίος χφησιμοποιείται ως μεταφφαστής λογικού επιπέδου [χ] και μετατφέπει την 4.6 V σε 3.3 V για να είναι συμβατό με την κάφτα microSD.

5.1.5 Arduino Nano

Το φολόι του Arduino Nano είναι στα 16 MHz, ωστόσο μία ADC (*Analog to Digital Converter*) μέτφηση έχει διάφκεια πεφίπου 90 κύκλους φολογιού, επομένως μποφούμε να κάνουμε δειγματοληψία του κύματος, πεφίπου στα 178 KHz, που είναι πολύ πιο γφήγοφο από το χφόνο δειγματοληψίας του Arduino. O τρόπος που το επιτυγχάνουμε αυτό είναι χρησιμοποιώντας έναν prescaler. Με αυτό μπορούμε να κάνουμε μέτρηση του παλμού κάθε 5.8 μs.

Ο ολοκληφωμένος κώδικας του Arduino Nano μποφεί να βφεθεί στο [22] και έχεις τις εξής λειτουφγίες:

- 1. Να θέσουμε το trigger threshold στο ADC
- 2. Να μετρήσει το πλάτος του παλμού από το κύκλωμα Peak detector
- 3. Να μετατρέψει το πλάτος του παλμού σε πλάτος του SiPM
- Να καταγράψει τη χρονική στιγμή του γεγονότος και το νεκρό χρόνο ανάμεσα σε δύο γεγονότα
- 5. Να ελέγχει την οθόνη OLED και το LED
- 6. Να στέλνει τα δεδομένα μέσω USB στον υπολογιστή
- 7. Να καταγράφει τα δεδομένα σε κάρτα microSD

Η αβεβαιότητα του παλμού ενεργοποίησης είναι περίπου 4 μs, λόγω της μειωμένης ταχύτητας δειγματοληψίας του Arduino Nano. Επίσης, όταν καταγράφουμε δεδομένα στον υπολογιστή υπάρχει ένα επιπλέον σφάλμα των 5 - 10 ms, λόγω της περιορισμένης ταχύτητας της σειριακής επικοινωνίας (στο ρυθμό baud 9600 bits / second).

Το Arduino, χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην οθόνη OLED κάθε δευτερόλεπτο. Στο κώδικα, μπορούμε να δούμε ότι το πρόγραμμά μας διακόπτεται κάθε 1.000.000 με για να ανανεώσει το ρολόι χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση getTime(). Η οθόνη μας δείχνει τον συνολικό χρόνο λειτουργίας, το νούμερο του μετρητή καθώς και το ρυθμό του, λαμβάνοντας υπόψη και τον ενδιάμεσο νεκρό χρόνο.

Συγκεκριμένα, το Count Rate (μετρητής) υπολογίζεται ως εξής:

 $Count Rate = \frac{A\rho i\theta\mu \delta\varsigma \gamma \varepsilon \gamma o\nu \delta\tau \omega\nu}{\frac{X\rho o\nu i\kappa \eta \sigma \tau i\gamma \mu \eta \gamma \varepsilon \gamma o\nu \delta\tau o\varsigma - X\rho o\nu i\kappa \eta \sigma \tau i\gamma \mu \eta \varepsilon \kappa \kappa i\nu \eta \sigma \eta \varsigma o\rho \gamma \delta\nu ov - N \varepsilon \kappa \rho \delta\varsigma \chi \rho \delta\nu o\varsigma}{1000} \varepsilon \xi. 5.1$



στο σχήμα παρακάτω φαίνεται η έξοδος της οθόνης OLED:

Σχήμα 5.6 Δεδομένα εξόδου που προβάλλει η οθόνη OLED

Ο νεκφός χφόνος υπολογίζεται μετφώντας το χφόνο που χφειάζεται το Arduino να εκτελέσει κάθε διαδικασία, αθφοίζοντάς τα και αφαιφώντας το από τον συνολικό τελικό χφόνο.

Το Arduino αναμένει σήμα μεγαλύτεφο από αυτό του trigger threshold στο Analog pin A0, μόλις το λάβει ξεκινάει η λήψη δεδομένων. Οι τιμές των mV που λαμβάνουμε ως είσοδο πφοσαφμόζονται σε ένα πλάτος παλμού ADC μετφάει από το 0 \rightarrow 1023 (2¹⁰ = 1024 τιμές ή 10 bit) και ο συσχετισμός mV - ADC φαίνεται από το παφακάτω διάγφαμμα:



Σχήμα 5.7 Σχέση συσχετισμού μετρημένου παλμού με τιμή ADC

5.2 Καταγραφή των δεδομένων

Υπάφχουν αφκετοί τφόποι να διαβάσουμε τα δεδομένα που καταγφάφει ο ανιχνευτής μας, ανάλογα με τη χφήση που θα κάνουμε, τα εφγαλεία και τις πηγές που θα έχουμε δίπλα μας όταν τον χφησιμοποιούμε. Αναλύονται παφακάτω.

5.2.1 Οθόνη OLED

Η οθόνη OLED βγάζει ως έξοδο τον συνολικό αφιθμό των παφατηφηθέντων γεγονότων (Total Count), τη χφονική διάφκεια που είναι ενεφγός ο ανιχνευτής μας (Uptime) και τον φυθμό των *counts* ανά δευτεφόλεπτο λαμβάνοντας υπόψην και τον νεκφό ενδιάμεσο χφόνο λειτουφγίας όπως δείξαμε στο σχήμα 5.4

5.2.2 Arduino Serial Monitor

Ποοκειμένου να καταγοάψουμε δεδομένα απευθείας από τον ανιχνευτή στον υπολογιστή μας θα ποέπει να συνδέσουμε τον ανιχνευτή με τον υπολογιστή μέσω USB.

- → Για λειτουργικό Mac, θα χρειαστεί να γίνει εγκατάσταση του driver CH340g [36] ώστε να διαβάζουμε δεδομένα από τη σειριακή θύρα
- → Για λειτουργικό Linux, χρειάζεται να αλλαχτούν τα δικαιώματα της θύρας USB από το terminal.

Συγκεκριμένα, με την εντολή: > sudo chmod 666 /dev/ttyUSB*

Μποφούμε να λάβουμε τα δεδομένα απευθείας από το Serial Monitor του Arduino IDE και να τα αντιγφάψουμε σε ένα αφχείο .txt. Σε αυτή τη μέθοδο βολεύει να εμφανίσουμε και το χφόνο του υπολογιστή για ακφιβέστεφες μετφήσεις. Τα δεδομένα έχουν την εξής μοφφή:

	Show timestamp	Newline	9600 baud	
18:33:29.228 -	-> 20 28940 240 41.21 1182 17.57			
18:33:27.605 -	-> 19 27313 124 23.92 1142 17.78			
18:33:27.367 -	-> 18 27075 448 112.41 1137 17.57			
18:33:27.330 -	-> 17 26999 140 25.42 1094 17.57			
18:33:26.883 -	-> 16 26619 496 144.49 1089 17.57			
18:33:26.537 -	-> 15 26264 472 125.87 1084 17.57			
18:33:24.959 -	-> 14 24667 608 202.86 1004 17.57			
18:33:24.853 -	-> 13 24561 606 221.61 1000 17.78			
18:33:23.583 -	-> 12 23314 399 87.30 960 17.57			
18:33:20.027 -	-> 11 19748 368 72.93 812 17.57			
18:33:18.341 -	-> 10 18055 147 26.19 773 17.35			
18:33:17.006 -	-> 9 16740 473 126.29 695 17.57			
18:33:13.494 -	-> 8 13235 639 249.88 577 17.35			
18:33:12.677 -	-> 7 12398 231 39.55 537 17.35			
18:33:12.677 -	-> 6 12384 414 93 93 533 17 57			
18:33:09.012 -	-> 5 8728 385 80 11 385 17 57			
18.33.07 021 -	-> 4 6750 504 143 61 306 17 35			
18.33.01.072	~ 3 3677 487 132 65 191 17 35			
18.33.00.723 -	~ 2 1390 432 101 61 115 17 35			
18.32.39.348 -	\sim 3 df _mili			
18.32.59.201 -	-> <i>ammannannannannannannannannannannannanna</i>	****	#	
18.32.59.172 -	-> ####################################	S] Temp[C] Num	1C +++	
18.32.59.150 -	-> ### Questions: suxuniemit.euu -> ### Comp date Comp time Event Andr time[ms] ADCE0_1023] SiDMEmVJ Deadtime[m	s] Tomp[(] Nan	20	
18.32.59.101 -	-> ### Cosmicwatch: The Desktop Muon Detector			
18.32.50 101 _	-> ### CosmicWatch: The Deskton Muon Detector			

Σχήμα 5.8 Δείγμα δεδομένων που λήφθηκαν από το Serial Monitor

5.2.3 Καταγραφή στον υπολογιστή μέσω Python script

Τα δεδομένα μποφούν να καταγφαφούν απευθείας στον υπολογιστή μας τφέχοντας το πφόγφαμμα import_data.py [28]. Το πφόγφαμμα αυτόματα θα

σκανάξει τις θύξες USB του υπολογιστή μας και θα ξωτήσει τον χξήστη να επιλέξει ποια θύξα είναι συνδεδεμένη με τον ανιχνευτή μας. Μόλις ο χξήστης επιλέξει, το πξόγξαμμα θα τον ξωτήσει τι θέλει να κάνει και θα εμφανιστούν οι παξακάτω επιλογές στα αγγλικά:

- (a) record the data to the computer,
- (b) save the data from the microSD card,
- (c) delete all the data on the microSD card,
- (d) connect the detector to the website

5.2.4 Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο μέσω ιστότοπου

Τα δεδομένα μποφούν να γίνουν plot σε πφαγματικό χφόνο στην ιστοσελίδα του πφότζεκτ <u>www.cosmicwatch.lns.mit.edu</u>. Για να χφησιμοποιήσουμε αυτή τη λειτουφγία πφοϋποθέτει πως ο χφήστης θα επιλέξει το (d), θα πφέπει να έχει ενεφγή σύνδεση στο διαδίκτυο. Έπειτα, επισκεπτόμαστε το *cosmicwatch.lns.mit.edu*, επιλέγουμε το κουμπί "Start data collection"

Start data collection

Στη συνέχεια συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δεδομένα και όταν ολοκληρώσουμε τις μετρήσεις μας, επιλέγουμε το κουμπί "Save" όπως φαίνεται παρακάτω:



Το αρχείο που δημιουργείται είναι της μορφής .txt, όπως μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα των δεδομένων στον <u>Πίνακα 3</u> του παραρτήματος. Επιπλέον, εάν επιθυμούμε μπορούμε και να φορτώσουμε παλαιότερο αρχείο δεδομένων

επιλέγοντας το κουμπί "Open". Τα αποτελέσματα και η οπτικοποίηση των μετρήσεων μέσω του ιστότοπου παρουσιάζονται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο.

5.2.5 microSD

Τα δεδομένα μποφούν επίσης να αποθηκευτούν απευθείας στην κάφτα microSD. Για να γίνει αυτό, θα πφέπει ο χφήστης πφώτα να έχει φοφτώσει τον κώδικα SDCard.ino [22] στο Arduino Nano. Κάθε φοφά που συνδέουμε τον ανιχνευτή ή γίνεται reset, ένα νέο αφχείο δεδομένων δημιουφγείται αυτόματα στη κάφτα microSD.

5.2.6 Μορφή των δεδομένων

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα εξαγόμενου αρχείου δεδομένων

### CosmicWatch: The Desktop Muon Detector					
### Questions? saxani@mit.edu					
### Device ID: 1					
### Comp_date Comp_time Event Ardn_time[ms] ADC_value[0-1023] SiPM[mV] Deadtime[ms]					

2022-02-16 18:35:18.027879 Ser_MKII					
2022-02-16 18:35:21.338800 1 3296 60.50 37.66 0					
2022-02-16 18:35:24.819769 2 6777 163.00 60.85 4					
2022-02-16 18:35:24.993933 3 6952 46.00 33.57 9					
2022-02-16 18:35:27.872539 4 9831 31.00 28.68 13					

Σχήμα 5.9: Ένα δείγμα της μορφής των καταγεγραμμένων γεγονότων όπως αποθηκεύτηκαν από τον ανιχνευτή μας. Στο πάνω μέρος έχουμε 6 γραμμές για την επικεφαλίδα. Στην 7η γραμμή φαίνεται το όνομα της συσκευής - Device ID, στη δική μας περίπτωση ονομάστηκε: Ser_MKII όταν εισαγάγαμε το κώδικα Naming.ino [22].

Η επικεφαλίδα περιγράφει το περιεχόμενο της εκάστοτε στήλης. Η πρώτη και η δεύτερη στήλη είναι η χρονική στιγμή όπως διαβάστηκε από το ρολόι του προσωπικού μας υπολογιστή και έχει ακρίβεια μερικά milliseconds, λόγω της περιορισμένης ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων από τη σειριακή θύρα. Η τρίτη στήλη στο σχήμα 5.7 αναπαριστά τον μετρητή γεγονότων. Όταν καταγράφονται δεδομένα στον μετρητή μας και πατηθεί το κουμπί reset ο μετρητής μας γίνεται 0. Η τέταρτη στήλη καταγράφει επίσης χρονική στιγμή σε milliseconds, αλλά αυτή ποοέοχεται από το εσωτερικό ρολόι του Arduino Nano. Ο λόγος που καταγράφουμε χρονικές στιγμές από δύο διαφορετικά ρολόγια είναι επειδή το ρολόι του Arduino δεν έχει μεγάλη ακρίβεια, σε διάστημα μιας ημέρας αναμένεται να δούμε διαφορά μερικών δευτερολέπτων. Στην πέμπτη στήλη μετράμε το πλάτος του ADC. Το πλάτος είναι μια τιμή από το 0 \rightarrow 1023. Στην έκτη στήλη μετράμε το πλάτος του παλμού του SiPM. Στην έβδομη στήλη (δεύτερη από το τέλος) είναι ο συνολικός "νεκρός χρόνος" που μετρήθηκε. Αυτή η μέτρηση είναι σημαντική, μιας και συνυπολογίζεται σε όλες μας τις μετρήσεις. Τέλος, στην όγδοη και τελευταία στήλη μπορούμε να δούμε τη θερμοκρασία σε κάθε χρονική στιγμή που λάβαμε μία μέτρηση.

5.3 Αντιμετώπιση Ποοβλημάτων

Η κατασκευή του οφγάνου πεφιέχει πολλά στάδια, και συναφμολόγηση πολλών στοιχείων, με αποτέλεσμα η πιθανότητα κάτι να μη δουλεύει είναι αφκετά μεγάλη. Ειδικά την πεφίοδο που έγινε η συγγφαφή της διπλωματικής εφγασίας, εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης εξαφτημάτων [23] και χφειάστηκε να παφαγγείλουμε πολλές φοφές παφεμφεφή υλικά. Σύμφωνα με τη βιβλιογφαφία και με αντίστοιχες υλοποιήσεις στο παφελθόν από άλλους φοιτητές σε όλο το κόσμο, τα πιο κοινά λάθη και απφοσεξίες κατά τη κατασκευή του οφγάνου είναι η χφήση λάθους εξαφτήματος και η ατελής κόλληση εξαφτήματος στην πλακέτα. Συγκεκφιμένα, τα λάθη παφατηφούνται στα εξαφτήματα που έχουν πολύ μικφά ποδαφάκια, όπως ο DC-DC booster (LT3461A) [44] ή ο τελεστικός ενισχυτής (LT1807) [45], όπως φαίνεται στο παφακάτω σχήμα η κλίμακα του ολοκληφωμένου συγκφιτικά με ένα κοινό ακουστικό.



Σχήμα 5.10 Μέγεθος ολοκληρωμένου (LT3461A) [44] συγκριτικά με ένα εμπορικού τύπου ακουστικό

Κατά τη διάφκεια της κατασκευής το πφόβλημα που αντιμετωπίσαμε, όπως πεφιγφάφηκε στο <u>4.2.3.1</u>, ήταν η βφαχυκύκλωση του LT3461A [44], με αποτέλεσμα να μη γίνεται σωστή ενίσχυση του σήματος. Το πφόβλημα λύθηκε αντικαθιστώντας το, ωστόσο ήταν πολύ δύσκολη διαδικασία και ενδέχεται να τραυματίστηκε και η πλακέτα κατά τη διάφκεια.

Επιπλέον, μετά από κάθε κόλληση ελέγχαμε με το πολύμετοο αν τοποθετήθηκε κάθε στοιχείο σωστά με οδηγό, το κύκλωμα του <u>Σχεδίου 3</u>.

Τα επιμέφους Data Sheets του κάθε ολοκληφωμένου, έπαιξαν καθοφιστικό φόλο στη καλύτεφη κατανόηση της λειτουφγίας του κάθε στοιχείου μεμονωμένα αλλά και ως μέφος ολόκληφης της διάταξης.

Σχετικά με τον σπινθηφιστή, χφειάστηκε ιδιαίτεφη πφοσοχή στη δημιουφγία των εσοχών με τη χφήση βιομηχανικού εξοπλισμού, καθώς δεν υπήφχε η γνώση από μέφους μας και χφειάστηκε η βοήθεια ειδικού για να μειωθεί η πιθανότητα λάθους.

Κεφάλαιο 6

Μετρήσεις & Συμπεράσματα

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε το τρόπο λήψης δεδομένων, τις τοποθεσίες που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις, το είδος των δεδομένων που λάβαμε, την επεξεργασία και οπτικοποίησή τους. Στη συνέχεια καταλήγουμε και σε μερικά συμπεράσματα για τη φύση των μετρήσεων καθώς και μελλοντικές εργασίες και βελτιώσεις.

Η πληθώφα των μετφήσεων βασίζεται στο Count Rate, δηλαδή το φυθμό των γεγονότων που καταγφάφει ο μετφητής ανά δευτεφόλεπτο. Θεωφητικά, αυτό το νούμεφο εξαφτάται όμως από μία πληθώφα παφαγόντων όπως, το υψόμετφο, την ακτινοβολία γάμμα από το φαδιενεφγό background (Σχήμα 2.1) κ.ο.κ. Μια καλή εκτίμηση είναι ότι ~ 0.5 Hz είναι γεγονότα κοσμικής ακτινοβολίας.

Σημειώνεται, πως εξαιτίας του όγκου των ληφθέντων δεδομένων (γραμμές πινάκων της τάξης των χιλιάδων) παρουσιάζονται παρακάτω μόνο διαγράμματα με αντίστοιχες αναφορές στο παράρτημα όπου υπάρχει μονοσέλιδο δείγμα των δεδομένων και με σύνδεσμο προς το πλήρες data set.

6.1 Μετρήσεις Πεδίου

6.1.1 Μέτρηση #01 & Βαθμονόμηση

Η πρώτη χρήση της συσκευής έγινε σε οικία για να δοκιμαστούν τα ηλεκτρονικά, να καλιμπραριστούν και να σιγουρευτούμε για την ομαλή λειτουργία της συσκευής. Τα δεδομένα αυτής της μέτρησης αποθηκεύτηκαν σε κάρτα εξωτερικής αποθήκευσης microSD.

Το όργανο το αφήσαμε για 1 ώρα εντός οικίας και κατέγραψε συνολικά 4.529 γεγονότα. Παρακάτω φαίνεται το Ιστόγραμμα των μετρήσεων. Θυμίζουμε, οι τιμές ADC, έχουν συσχετιστεί παραπάνω στο <u>Σχήμα 5.4</u>. Τα δεδομένα μπορείτε να τα βρείτε στο Παράρτημα, στον <u>πίνακα 4</u>.



Histogram of ADC[0-1023]

Διάγραμμα 6.1 Ιστόγραμμα μετρήσεων συναρτήσει των τιμών ADC που καταχώρησε το Arduino

Παφατηφούμε πως οι τιμές ADC ξεκινάνε από το 80 και πάνω. Αυτό γίνεται μιας και θέσαμε εμείς αυτό το κατώφλι στο κώδικα του Arduino λόγω του αυξημένου φυθμού γεγονότων που λαμβάναμε, επομένως ότι σήμα λαμβάνεται σε μικφότεφες τάσεις αποκόπτεται και δε καταγφάφεται μιας και

πρόκειται κυρίως για θόρυβο. Είναι φυσιολογικό η πλειοψηφία των γεγονότων να τείνει στα αριστερά του ιστογράμματος, καθώς η καταγραφή γεγονότος με τόση ενέργεια που να αντιστοιχεί στις μέγιστες τιμές του ADC (1023) είναι αρκετά σπάνιο και θα χρειαστεί ο ανιχνευτής να καταγράφει για αρκετή ώρα.

Παρακάτω υπάρχει το αντίστοιχο ιστόγραμμα αλλά με όλες τις τιμές που καταχωρήθηκαν από το Arduino.



Διάγραμμα 6.2 Ιστόγραμμα τιμών που καταχωρήθηκαν από τον μικροελεγκτή συναρτήσει των τιμών σε mV που κατέγραψε το Arduino σε 1 ώρα λειτουργίας

Διακρίνεται ξεκάθαρα το πλήθος των σημάτων χαμηλής έντασης, κοντεύουν τα 1.000.

Τέλος, όσον αφορά το Count Rate, δηλαδή το ρυθμό καταγραφής γεγονότων ανά δευτερόλεπτο, έχουμε το παρακάτω διάγραμμα για τη διάρκεια 59 λεπτών. Παρατηρούμε ότι ο ρυθμός σταθεροποιείται μετά από το πρώτο 20λεπτο. Συγκεκριμένα, σε αυτή τη δειγματοληψία το Count Rate ηταν στο 1.29 (γεγονότα ανά δευτεφόλεπτο). Υπενθυμίζουμε το Count Rate από την εξ. 5.1 υπολογίζεται ως εξής:



Διάγραμμα 6.3 Count Rate που υπολογίστηκε σε 59 λεπτά λειτουργίας του οργάνου

6.1.2 Μέτρηση #02 & Χρήση ιστοσελίδας για ζωντανή προβολή

Η χρήση του ιστότοπου για ζωντανή καταγραφή των γεγονότων αποδείχτηκε πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα ως προς την οπτικοποίηση των δεδομένων και άρα στη καλύτερη κατανόηση της πειραματικής διάταξης. Έγινε μια αρχική αναφορά στο <u>5.3.3</u> και παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τα δεδομένα. Υπενθυμίζουμε πως αυτά τα δεδομένα αντιστοιχούν στον <u>Πίνακα 3</u> του παραρτήματος.

X At this point we've collected 4436 hits!



Διάγραμμα 6.4 Ζωντανή αναπαράσταση ιστογράμματος γεγονότων. Συνολικά καταγράφηκαν 4436 γεγονότα και φαίνεται κάθε χρονική στιγμή το πλήθος των γεγονότων

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό το δείγμα των μετρήσεων έγινε στον ίδιο χώρο με τις μετρήσεις του <u>6.1.1</u>.



Διάγραμμα 6.5 (α) Πλήθος γεγονότων/σημάτων ανά χρόνο δειγματοληψίας. (β) Πλήθος γεγονότων ανά χρόνο ανάμεσα στα σήματα. (γ) Count Rate, ρυθμός γεγονότων καθ' όλη τη διάρκεια των μετρήσεων. (δ) Ιστόγραμμα πλάτους των σημάτων

Από τα παραπάνω διαγράμματα αξίζει να σημειωθεί ότι:

- Σύμφωνα με το 6.4 (γ) παρατηρείται και εδώ ότι το Count Rate σταθεροποιείται μετά από τα πρώτα 12 λεπτά λειτουργίας.
- 2. Το Count Rate ~1.612 είναι αξιοσημείωτα υψηλότερο από τη μέτρηση της ενότητας <u>6.1.1</u> η οποία ήταν ~1.29. Παρά το γεγονός ότι έγιναν στον ίδιο χώρο, ίδια ώρα και με μια μέρα διαφορά. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αρκετούς λόγους:
 - a. Να υπήρχε κάποιο υλικό, συσκευή η οποία να εξέπεμπε
 ακτινοβολία και να πυροδότησε τον σπινθηριστή.
 - b. Το φολόι του υπολογιστή είναι πολύ πιο ακφιβές απ'ότι αυτό του Arduino. Επομένως, στο βάθος μιας ώφας η διαφοφά να μεγιστοποιείται μιας και καταγφάφονται πεφισσότεφα γεγονότα στον ίδιο χφόνο άφα ο φυθμός αυξάνεται.
 - c. Διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και στα επίπεδα φωτισμού

Η παφαπάνω μέθοδος, αν και πολύ χφήσιμη στην άμεση οπτικοποίηση των μετφήσεων, είναι χφονοβόφα μέχφι να συνδεθεί το όφγανο με το διαδίκτυο, να μποφέσει να επικοινωνήσει τα δεδομένα του αναλόγως το λογισμικό που χφησιμοποιούμε, καθώς απαιτείται διαδικασία από τον χφήστη για εγκατάσταση συγκεκφιμένων βιβλιοθηκών ή πακέτων της Python.

Ενδείκνυται αυτή η μέθοδος ποοβολής και αποθήκευσης δεδομένων σε περιπτώσεις διαλέξεων και επεξήγηση της λειτουργίας της συσκευής.

Έπειτα από την ασυμφωνία των δυο παραπάνω μετρήσεων καταλήξαμε πως θα ήταν αποδοτικότερο στο μέλλον οποιαδήποτε καταγραφή και σύγκριση αποτελεσμάτων να γίνει με τις ίδιες μεθόδους και συνθήκες, ώστε να λιγοστέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο οι παράμετροι και να καταλήξουμε σε ορθότερα συμπεράσματα.

6.1.3 Μέτρηση #03 - Περιοχή κέντρου Αθηνών

Αφού ολοκληφώσαμε τις δοκιμές και σιγουφευτήκαμε για τη μέθοδο λήψης δεδομένων δοκιμάσαμε τον ανιχνευτή σε εξωτεφικό χώφο. Συγκεκφιμένα, στη πεφιοχή του Μοναστηφακίου, στην Αθήνα. Η πφώτη μέτφηση θα γινόταν στο μετφό το οποίο θεωφείται από τους βαθύτεφους σταθμούς της Αττικής, στα 32 μέτφα [31] και αμέσως μετά ακολούθησε άλλη μια μέτφηση στην επιφάνεια. Με βάση τη θεωφία και ότι αναφέφθηκε στο <u>Κεφάλαιο 2</u>, η κοσμική ακτίνα και τα παφάγωγά της μέχφι να φτάσουν στην επιφάνεια της θάλασσας έχουν ήδη χάσει πολλή ενέφγεια, βάζοντας λοιπόν ένα εμπόδιο πέτφας πάχους 30 μέτφων θεωφητικά θα μειώσει κατά πολύ τη φοή των σωματιδίων.

Και στις 2 μετρήσεις ο μετρητής λάμβανε δεδομένα για 58 λεπτά.

Οι υπόγειες μετφήσεις φαίνονται αναλυτικά στον <u>Πίνακα 5</u> του παφαφτήματος, ενώ οι υπέφγειες μετφήσεις που λάβαμε, παφουσιάζονται στον <u>Πίνακα 6</u>. Κατά τη διάφκεια λήψης των παφαπάνω μετφήσεων ήμασταν ιδιαίτεφα πφοσεκτικοί ώστε οι συνθήκες των δύο δειγματοληψιών να είναι όσο το δυνατόν ίδιες. Συγκεκφιμένα, ο μετφητής τοποθετήθηκε κάθετα μέσα σε κλειστή τσάντα ενώ είχε εσωτεφική παφοχή φεύματος από power bank.



Διάγραμμα 6.6 Count Rate για τις 2 μετρήσεις. Με μπλέ είναι η υπόγεια μέτρηση, ενώ με κόκκινο η υπέργεια.

Οι θεωφητικές πφοβλέψεις επιβεβαιώθηκαν, μιας και ο φυθμός μέτφησης γεγονότων (Count Rate) για την υπόγεια μέτφηση (μπλε γφαμμή) ήταν ~0.83 γεγονότα ανά δευτεφόλεπτο, ενώ η υπέφγεια μέτφηση (κόκκινη γφαμμή) ήταν στο ~0.92 γεγονότα ανά δευτεφόλεπτο. Και εδώ παφατηφούμε πως το CR σταθεφοποιείται μετά από το πφώτο 10λεπτο.

Μιας και οι παφαπάνω μετφήσεις ήταν ποιοτικές πφοχωφήσαμε σε πεφαιτέφω ανάλυση των δεδομένων με τη βοήθεια ενός script στη Python [29] για να παφάξουμε πεφισσότεφα διαγφάμματα για να αποκτήσουμε καθολική εικόνα του πειφάματος και των μετφήσεων. Παφακάτω φαίνεται μια άλλη οπτικοποίηση των φυθμών (Count Rates) έχοντας συμπεφιλάβει τα σφάλματα.



Διάγραμμα 6.7 Count Rate για τις 2 μετρήσεις. Με πράσινο η υπόγεια μέτρηση ενώ με κόκκινο η μέτρηση επιφάνειας.



Διάγραμμα 6.8 Ρυθμός ανά μετρημένης τάσης από τον SiPM. Με κόκκινο η υπόγεια μέτρηση, ενώ με πράσινο η μέτρηση στην επιφάνεια.

Το παραπάνω διάγραμμα έχει ενδιαφέρον μιας και παρατηρούμε πως στην επιφάνεια ο SiPM έλαβε μεγαλύτερης έντασης σήματα, σε σχέση με τις μετρήσεις εντός του μετρό.

Γεγονός που επιβεβαιώνεται και πειραματικά από τη βιβλιογραφία.

6.2 Μελλοντικές Μετρήσεις

Οι παραπάνω μετρήσεις ήταν μια καλή αρχή για πειραματισμό και επιβεβαίωση της υπάρχουσας θεωρίας περί κοσμικής ακτινοβολίας και πως αλληλεπιδρά με την ύλη.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων στη κάρτα microSD μιας και καθιστά την συσκευή φορητή. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια εξωτερική παροχή ενέργειας για να τροφοδοτεί το Arduino, π.χ ένα power bank.

Μελλοντικές μετρήσεις θα μπορούσαν να γίνουν:

- Σε μεταλλεία λατομεία όπου υπάρχει πρόσβαση σε υπόγειες διαβάσεις και να αναλυθούν τα δεδομένα ανάλογα με τα διάφορα πετρώματα.
- 2. Κατά τη διάρκεια πτήσης, όσο μεγαλύτερη απόσταση και υψόμετρο τόσο το καλύτερο αφού όσο ψηλότερα βρισκόμαστε στην ατμόσφαιρα τόσο αυξάνεται η συχνότητα των γεγονότων μιας και τα μιόνια δε προλαβαίνουν να διασπαστούν. Για να γίνουν όμως οι συγκεκριμένες μετρήσεις κατά τη διάρκεια πτήσης, θα χρειαστούν ειδικές άδειες συμφωνία με την αεροπορική γραμμή μιας και πρόκειται για εξειδικευμένο όργανο μέτρησης.
- 3. Σε κοουφή βουνού, ιδανικά σε υψόμετοο μεγαλύτεοο από 2,5 km. Στην Ελλάδα υπάοχουν αρκετές επιλογές. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας, μιας και το όργανο δεν έχει δοκιμαστεί (ακόμα) σε θερμοκρασίες χαμηλότερες του μηδενός.
- Υποβούχια μέτοηση, μιας και το νεοό είναι ομογενές υλικό και υπάοχει άφθονο στον πλανήτη. Ίσως θα μπορούσε να βγει μία αναλογία ουθμού
 βάθους. Οι ποοκλήσεις του συγκεκοιμένου πειράματος είναι η δημιουργία αεροστεγούς θήκης η οποία θα συμπεριλαμβανει πέρα από

τον μετρητή και πηγή ενέργειας και φυσικά, η τοποθέτηση του οργάνου σε σημείο που θα παραμείνει ακίνητο για επαρκές χρονικό διάστημα, ίσως με τη χρήση βαριδιών.

- 5. Σε διάφορες καιρικές συνθήκες, μιας και όπως αναλύσαμε στο <u>Κεφάλαιο</u> 2 η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας παίζει σημαντικό ρόλο στο ρυθμό διάσπασης των κοσμικών ακτίνων. Επομένως, μετρήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος ίσως μας προσέφεραν ενδιαφέρον οπτικές στην αλληλεπίδραση καιρού - ακτινοβολίας.
- Σε κάποιο εργαστήριο πυρηνικής φυσικής όπου υπάρχουν ραδιενεργά υλικά ώστε να δούμε πως αντιδράει ο μετρητής ανάλογα με τα υλικά.

6.3 Βελτιώσεις & προτάσεις για το μέλλον

Όπως αναφέφθηκε παφαπάνω, το συγκεκφιμένο όφγανο έχει μια απλότητα στη κατασκευή του συγκφιτικά με αντίστοιχους μετφητές στην αγοφά, αλλά στο πλαίσιο της παφούσας διπλωματικής μελέτης τα χαφακτηφιστικά του ήταν επαφκή για τα συμπεφάσματα που θέλαμε να βγάλουμε.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια κατασκευής παρατηρήθηκαν ορισμένοι τομείς που χωράνε περιθώρια βελτίωσης ή πρακτικές που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν στο μέλλον. Αναλύονται παρακάτω:

Σχετικά με τα υλικά

Λόγω της μαζικής πώλησης των πεφισσότεφων στοιχείων κατέληξε να υπάφχει μεγάλο πλεόνασμα στοιχείων, γεγονός που διευκολύνει τη κατασκευή εφεδφικών οφγάνων ωστόσο αυξάνεται δφαματικά και το κόστος όπως στη πφοκειμένη πεφίπτωση. Επομένως, σε μελλοντικές κατασκευές ίσως είναι καλύτεφη πφακτική να γίνει η κατασκευή οφγανωμένα σε επίπεδο εφγαστηφίου ή κάποιου μαθήματος ώστε να γίνουν μαζικές παφαγγελίες, να παφαχθούν αρκετοί ανιχνευτές και να μειωθεί το κόστος. Θεωρητικά θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και ~100 € / ανιχνευτή.

Σχετικά με το κύκλωμα

Το κύκλωμα έχει διαμοφφωθεί έτσι ώστε να επιτελεί μεφικές βασικές λειτουφγίες επεξεφγασίας σήματος και αποθήκευση και πφοβολή δεδομένων μέσω του μικφοελεγκτή. Η επιλογή του Arduino για μικφοελεγκτή, αν και διευκολύνει τους χφήστες μιας και είναι ευφέως διαδεδομένο έφχεται με τους πεφιοφισμούς του. Συγκεκφιμένα, με το μέγεθος της μνήμης όπως αναλύθηκε στο 4.2.2, και με το σφάλμα στο φολόι 5.1.6. Αν και τα παφαπάνω χαφακτηφιστικά, στο πλαίσιο της παφούσας διπλωματικής μελέτης δεν επηφέασαν ιδιαίτεφα τα αποτελέσματα, ενδέχεται σε μελλοντικές μετφήσεις σε πιο αντίξοες συνθήκες να υπάφξουν αποκλίσεις και ανακφίβειες.

Το πρόβλημα με το ρολόι μπορεί να επιλυθεί συνδέοντας το όργανο με υπολογιστή και στις μετρήσεις να καταχωρείται ο χρόνος από το εσωτερικό ρολόι του υπολογιστή, ο οποίος είναι πολύ πιο ακριβής. Ωστόσο, αυτή η προσωρινή λύση αν και μας προσφέρει ακριβέστερα δεδομένα φέρνει ακόμη περισσότερα προβλήματα στο κομμάτι της φορητότητας. Μια άλλη προσέγγιση στη λύση του προβλήματος είναι η χρήση ενός φορητού υπολογιστή τύπου Raspberry Pi [25] ο οποίος θα λειτουργεί ως διαμεσολαβητής των δεδομένων. Ειδικά στη περίπτωση που μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στον μετρητή απ' όπου και αν βρισκόμαστε.

Μία άλλη προτεινόμενη λύση και στα δύο προαναφερθέντα προβλήματα της μνήμης και του ρολογιού είναι η αντικατάσταση του μικροελεγκτή. Ωστόσο, αυτό το βήμα απαιτεί αρκετό επανασχεδιασμό στο κύκλωμα και τα στοιχεία του. Όμως, στη περίπτωση που θέλουμε πιο ακριβείς μετρήσεις, σε μεγαλύτερο εύρος πεδίου και για περισσότερο χρόνο, είναι η μόνη λύση.

Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα προσθήκης μικρών επεκτάσεων στο Arduino όπως σύνδεση με bluetooth [27], WiFi [34] κλπ. τα οποία μπορούν να μας

προσφέρουν επιπλέον συνδεσιμότητα και ευκολία στην διεπαφή μεταξύ οργάνου και χρήστη.

Βιβλιογραφία

- Hess, V. (n.d.). On the Observations of the Penetrating Radiation during Seven Balloon Flights. <u>https://arxiv.org/abs/1808.02927</u>
- [2] Oh-My-God particle. (n.d.). Wikipedia. Retrieved March 6, 2022, from https://en.wikipedia.org/wiki/Oh-My-God_particle
- [3] ESA Planck CMB. (n.d.). European Space Agency. Retrieved March 6, 2022, from <u>https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2013/03/Planck_CMB</u>
- [4] Halzen, F., & Martin, A. D. (1984). Quarks and leptons.
- [5] D. Griffiths, Introduction to elementary particles. John Wiley & Sons, 2008.
- [6] Davies, B. (2022, January 31). Cosmic Rays. AntarcticGlaciers.org. Retrieved March 6, 2022, from <u>https://www.antarcticglaciers.org/glacial-geology/dating-glacial-sediments-2</u> /cosmic-rays/
- [7] Compton scattering. (n.d.). Wikipedia. Retrieved March 6, 2022, from https://en.wikipedia.org/wiki/Compton scattering
- [8] Serway, R. A. (2000). Synchronē physikē (P. Sophronios, Trans.).Panepistēmiakes Ekdoseis Krētēs.
- [9] Beatty, J., & Matthews, J. (2014, August 21). 28. COSMIC RAYS. Retrieved March 6, 2022, from <u>http://personalpages.to.infn.it/~zaninett/projects/cosmic/cosmicrayrpp.pdf</u>
- [10] Grieder, P.K.F. (2001). Cosmic Rays at Earth (P.K.F. Grieder, Ed.). Elsevier Science.
- [11] Representation of Earth's Invisible Magnetic Field. (2011, December 5).NASA. Retrieved March 6, 2022, from

https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/gallery/Earths-magneti cfieldlines-dipole.html

- [12] Space Station Research Explorer on NASA.gov. (n.d.). NASA. Retrieved March 6, 2022, from <u>https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/explorer/</u> <u>Investigation.html?#id=1013</u>
- Kloss, C. (2020, October 20). The CHAOS-7 geomagnetic field model and observed changes in the South Atlantic Anomaly - Earth, Planets and Space. Earth, Planets and Space. Retrieved March 6, 2022, from <u>https://earth-planets-space.springeropen.com/articles/10.1186/s40623-020-012</u> <u>52-9#citeas</u>
- [14] Geiger counter. (n.d.). Wikipedia. Retrieved March 6, 2022, from <u>https://en.wikipedia.org/wiki/Geiger_counter#/media/File:Geiger-Muller-counter-en.png</u>
- BC-400, BC-404, BC-408, BC-412, BC-416. (n.d.). Crystals Saint-Gobain. Retrieved 2 26, 2022, from <u>https://www.crystals.saint-gobain.com/radiation-detection-scintillators/plast</u> <u>ic-scintillators/bc-400-bc-404-bc-408-bc-412-bc-416</u>
- BC-408 Datasheet. (n.d.). Crystals Saint-Gobain.
 <u>https://www.crystals.saint-gobain.com/sites/hps-mac3-cma-crystals/files/202</u>
 <u>1-10/BC400-404-408-412-416-Data-Sheet.pdf</u>
- [17] Fraser, G. (2002, November 1). More to physics than meets the eye CERN Courier. CERN Courier. Retrieved March 6, 2022, from <u>https://cerncourier.com/a/more-to-physics-than-meets-the-eye/</u>
- [18] Dieguez, A. (n.d.). Silicon Photomultiplier Concepts, Characteristics, Prospects. CERN Indico. Retrieved March 6, 2022, from

https://indico.cern.ch/event/236750/contributions/509304/attachments/397020 /552180/8-2-jendrysik.pdf

- [19] MICROC-SERIES Silicon Photomultipliers (SiPM), Low-Noise, Blue-Sensitive. (n.d.). onsemi. Retrieved March 6, 2022, from <u>https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/microc-series-d.pdf</u>
- [20] Silicon Photomultipliers (SiPM). (n.d.). onsemi. Retrieved March 6, 2022, from <u>https://www.onsemi.com/products/sensors/photodetectors-sipm-spad/silico</u> <u>n-photomultipliers-sipm</u>
- [21] ON Semiconductor Is Now. (n.d.). ON Semiconductor Is Now. Retrieved March 6, 2022, from <u>https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9770-D.PDF</u>
- [22] Axani, S. (n.d.). CosmicWatch-Desktop-Muon-Detector-v2. github.com. Retrieved 2, 2022, from <u>https://github.com/spenceraxani/CosmicWatch-Desktop-Muon-Detector-v2/</u> <u>blob/master/Arduino/</u>
- [23] 2020–present global chip shortage. (n.d.). Wikipedia. Retrieved March 6,
 2022, from
 <u>https://en.wikipedia.org/wiki/2020%E2%80%93present_global_chip_shortag_e</u>
- [24] Axani, S. (n.d.). Desktop-Muon-Detector-v2. github.com. <u>https://github.com/spenceraxani/CosmicWatch-Desktop-Muon-Detector-v2/</u> <u>blob/master/PCB_Files/PCB_Gerber_files.zip</u>
- [25] (n.d.). Teach, Learn, and Make with Raspberry Pi. Retrieved March 9, 2022, from https://www.raspberrypi.org/

- [26] Axani, S. (n.d.). Desktop-Muon-Detector-v2. github.com. https://github.com/spenceraxani/CosmicWatch-Desktop-Muon-Detector-v2/ blob/master/Enclosure_Files/EndPlates_laser_cut_files.zip
- [27] Interfacing Bluetooth Module (HC-05) with Arduino Uno. (2020, April 29). Arduino Cloud Maker Plan. Retrieved March 9, 2022, from <u>https://create.arduino.cc/projecthub/akshayjoseph666/interfacing-bluetooth-module-hc-05-with-arduino-uno-f5209b</u>
- [28] Przewlocki, P. (n.d.). CosmicWatch-Desktop-Muon-Detector-v2/import_data.py at master · spenceraxani/CosmicWatch-Desktop-Muon-Detector-v2. GitHub. Retrieved March 9, 2022, from <u>https://github.com/spenceraxani/CosmicWatch-Desktop-Muon-Detector-v2/</u> <u>blob/master/Recording_Data/import_data.py</u>
- [29] ExampleiPythonNotebook.ipynb. (n.d.). github.com. https://github.com/spenceraxani/CosmicWatch-Desktop-Muon-Detector-v2/ blob/master/Recording_Data/ExamplePlots/ExampleiPythonNotebook.ipynb
- [30] (n.d.). Amazon.de: Günstige Preise für Elektronik & Foto, Filme, Musik, Bücher, Games, Spielzeug & mehr. Retrieved March 6, 2022, from <u>http://amazon.de</u>
- [31] Σε τι βάθος κινούνται οι συομοί του Μετοό στην Αθήνα;. (2022, March 2). carandmotor. Retrieved March 9, 2022, from <u>https://www.carandmotor.gr/nea/metro-se-ti-bathos-kinoyntai-oi-syrmoi-sti</u> <u>n-athina</u>
- [32] P. Eckert et al., "Characterisation studies of silicon photomultipliers", Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 620, 217–226 (2010)
- [33] (n.d.). eBay: Electronics, Cars, Fashion, Collectibles & More. Retrieved March
 6, 2022, from <u>http://ebay.com</u>

- [34] van Slooten, F. (2018, March 17). Connect an ESP8266 module to an Arduino Nano and control it with Blynk - vanslooten.com. Fjodor van Slooten. Retrieved March 9, 2022, from <u>https://home.et.utwente.nl/slootenvanf/2018/03/17/connect-esp8266-control-b</u> <u>lynk/</u>
- [35] Software. (2021, December 20). Arduino. Retrieved March 6, 2022, from https://www.arduino.cc/en/software
- [36] adrianmihalko/ch340g-ch34g-ch34x-mac-os-x-driver: CH340G CH34G CH34X Mac OS X driver. (n.d.). GitHub. Retrieved March 6, 2022, from <u>https://github.com/adrianmihalko/ch340g-ch34g-ch34x-mac-os-x-driver</u>
- [37] [1801.03029] The CosmicWatch Desktop Muon Detector: a self-contained, pocket sized particle detector. (2018, January 9). arXiv. Retrieved March 6, 2022, from <u>https://arxiv.org/abs/1801.03029</u>
- [38] Chambers, S. (2021, January 13). Polyimide Tape and Kapton Tape. Strouse. Retrieved March 6, 2022, from <u>https://www.strouse.com/blog/polymide-and-kapton-tape</u>
- [39] Axani, S. (n.d.). CosmicWatch-Desktop-Muon-Detector-v2. github.com. <u>https://github.com/spenceraxani/CosmicWatch-Desktop-Muon-Detector-v2/t</u> <u>ree/master/CAD</u>
- [40] Zormpas, S. G. (n.d.). Data set for Muon detector [6.1.2]. <u>https://drive.google.com/file/d/17yXgPc6NmePHy1IH-iFL7H78pdzgxay0/vie</u> <u>w</u>
- [41] Zormpas, S. G. (n.d.). Data set for Muon detector [6.1.1]. https://drive.google.com/file/d/1OxJyO_eK8RSLbp3r_hmKT855LJ2vjJUs/vie W

- [42] Zormpas, S. G. (n.d.). Data set for Muon detector [6.1.3].
 <u>https://drive.google.com/file/d/17yXgPc6NmePHy1IH-iFL7H78pdzgxay0/vie</u>
 <u>w</u>
- [43] Linear Technology. (n.d.). Wikipedia. Retrieved March 9, 2022, from https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_Technology
- [44] LT3461/LT3461A 1.3MHz/3MHz Step-Up DC/DC Converters with Integrated Schottky in ThinSOT. (n.d.). Analog Devices. Retrieved March 9, 2022, from <u>https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/346</u> <u>1Afa.pdf</u>
- [45] LT1806/LT1807 325MHz, Single/Dual, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps. (n.d.). Analog Devices. Retrieved March 9, 2022, from <u>https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/180</u> <u>67fc.pdf</u>

Παράρτημα

Ανιχνευτής							
a/a	Ονομασία	Απαιτούμενο	Κόστος ανα	Συνολικό κόστος	Αγοράστ	Περιγραφή	Σύνδεσμος / Part number
1	0.0hm resistor	5	€0.03	€0.27	10	RES SMD 0 OHM JUMPER	Digikey Part Number: 311-0 04PCT-ND
	U UNIT CSISCO		60.04	60.0F	10		https://gr.mouser.
2	49.9 Ohm resistor	4	€0.04	€0.35	10	RES SMD 49.9 OHM 1% 1/8W 0805	com/ProductDetail/YAGEO/RC0805FR-0749R9L? gs=VLOqbHBAO5FOTWOXSZvQ2A%3D%3D
3	249 Ohm resistor	2	€0.04	€0.44	10	RES SMD 249 OHM 1% 1/4W 0805	https://www.digikey.gr/product-detail/en/CR0805-FX- 2490ELF/118-CR0805-FX-2490ELFCT-ND/10673734? itemSeg=382836950
4	1K resistor	4	€0.04	€0.37	10	RES SMD 1K OHM 1% 1/8W	Digikey Part Number: 311-1 00KCRCT-ND
5	10k resistor	5	€0.04	€0.37	10	RES SMD 10K OHM 1% 1/8W	Digikey Part Number: 311-10 0KCPCT-ND
с с	24.0k socistos	2	€0.09	€0.18	2	RES SMD 24.9K OHM 1% 1/8W	Digikey Part Number: STI TO OKCKET ND
7		3	€0.04	€0.37	10	RES SMD 100K OHM 1% 1/8W	Digikey Pat Number, RMCP0005F12445CFND
1		2	€0.04	€0.37	10	RES SMD 226K OHM 1% 1/8W	
8	226k resistor	_				0805	Digikey Part Number: 311-226KCRCI-ND https://gr.mouser.com/ProductDetail/Samsung-
9	10pF capacitor	2	€0.05	€0.49	10	CAP CER 10PF 50V COG/NP0 0805	Electro-Mechanics/CL21C100JBANNNC?qs=% 2Fha2pyFaduje% 252BmboLt0eZabYuUApeUnxHnCxem6fmq7NKSoMYd C%252BA%3D%3D
10	22pF capacitor	2	€0.09	€0.45	5	CAP CER 22PF 50V NP0 0805	Digikey Part Number: 399-1113-1-ND
11	0.47uF capacitor	2	€0.28	€1.40	5	CAP CER 0.47UF 50V X7R 0805	Digikey Part Number: 399-8100-1-ND https://www.digikey.gr/en/products/detail/kyocera- avs/08051C203KAT2A/1601364?
12	20 nF capacitor	6	€0.03	€0.27	10	CAP CER 20nF 50V X7R 0805	
13	0.1uF capacitor	4	€0.07	€0.66	10	CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805	https://gr.mouser.com/ProductDetail/? gs=Pc30aiB8zWUISNb2Qeyxfw%3D%3D
14	1uF capacitor	3	€0.11	€0.55	5	CAP CER 1UF 50V X7R 0805	Digikey Part Number: 1276-6470-1-ND
15	10nF capacitor	4	€0.04	€0.37	10	0805	Digikey Part Number: 1276-1249-1-ND
16	10uF capacitor	3	€0.19	€1.14	6	CAP CER 10UF 16V X5R 0805	https://www.digikey.gr/product- detail/en/CL21A106KOFNNNE/1276-2893-1- ND/3890979?itemSeq=382838479
17	Feritte bead	2	€0.05	€0.54	10	FERRITE BEAD 2.5 KOHM 0805 1LN	https://gr.mouser.com/ProductDetail/963- BK2125LM252-T
18	47uH inductor	1	€0.16	€0.31	2	FIXED IND 47UH 170MA 1.3 OHM SMD	Digikey Part Number: 490-4063-1-ND
19	Schottky diode	2	€0.12	€12.00	100	DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOD123	https://gr.rsdelivers. com/product/onsemi/mbr0540t1g/onsemi-40v-500ma- schottky-diode-2-pin-sod-123/0463842
20	4 pin header for OLED	1	€0.49	€0.49	1	CONN FEMALE 4POS .100" R/A TIN	Digikey part number: S5440-ND
21	6-pip connector	1	€0.67	€0.67	1	6-pip connector for SiPM PCB	https://www.digikey. gr/ep/products/detail/moley/0879209112/4554996
22	6pin header	1	€1.84	€1.84	1	6-pin header for Main PCB	Digikey Part Number: 1212-1229-ND
23	Reset button	1	€0.20	€0.40	2	SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V	Digikey part number: P12215S-ND
24	3.5mm coincidence iack	1	€0.94	€0.94	1	3.5mm audio, 4 conductor connection iack	https://gr.mouser.com/ProductDetail/CUI-Devices/SJ- 43515RS-SMT-TR?qs=WyilAZoYn539wol% 252BXvq5nw%3D%3D
25	BNC header + Nut	1	€3.13	€3.13	1	CONN BNC JACK R/A 50 OHM PCB	Digikey part number: A97555-ND (old version WM5514-ND)
26	3 3 V regulator	1	€0.17	€17.00	100	IC REG LINEAR 3.3V 300MA	https://gr.rsdelivers. com/product/diodeszetex/ap2210n- 33trg1/diodeszetex-ap2210n-33trg1-1-low-dropout- voltage-3/8287426
27	Standoff for SiDM DCB	2				1/8" Hex Size, 7/16"" Length, 0	McMasterCarr part number: 01780A020
28	Standoff threaded screws 0- 80	4	€27.83	€27.83		0-80 Thread Size, 1/4" Long	McMasterCarr part number: 91771A055
29	Plastic scintillator screws	4				18-8 Stainless Steel, Number 0 Size, 5/16" Long	McMasterCarr part number: 92470A024
30	IT-3461 DC-DC Booster	1	€5.12	€10.24	2	IT3461ES6#TDDBE	https://gr.rsdelivers.com/productpage/productpage?
50	EP3401 DC-DC BOOSICE	1	€7.50	€7.50	1		https://www.analog.com/en/products/lt1807. https://www.analog.com/en/products/lt1807. html#product-samplebuy https://www.digikey.gr/en/products/detail/analog- devices-inc/L11807IS8-PBF/9629552 s=N4IqTCBcDaIDIBUCMAOADAdg.JIGUUGIAFAIQDEQB
31	LT 1807 Op-Amp					LT1807IS8#PBF	dAXyA https://www.digikey.gr/product-
32	Non-Inverting Buffer	1	€0.47	€0.94	2	High Speed CMOS Logic Hex Non-Inverting Buffers	detail/en/CD74HC4050M96/296-14529-1-ND/555596? itemSeq=382831459 https://orobotronics.com/oloctronics
33	5mm LED	1	€0.20	€0.40	2	5mm, white looks best	components/led/5mm-leds/?sl=en
34	Arduino Nano	1	€6.00	€12.00	2	ATmega328 CH340G	https://grobotronics.com/arduino-nano-compatible- ch340-with-headers.html
35	Temperature sensor	1	€1.60	€1.60	1	TMP36 analog sensor	https://gr.mouser.com/ProductDetail/584-TMP36GT9Z
36	microSD card socket	1	€1.35	€8.12	6	SD Memory Card Slot Holder Sockets	https://www.ebay.com/itm/363387069189

a/a	Ονομασία	Απαιτούμενο πλήθος	Κόστος ανα μονάδα	Συνολικό κόστος	Αγοράστ ηκαν	Περιγραφή	Σύνδεσμος / Part number
37	OLED screen	1	€14.05	€14.05	1	0.96" Inch I2c IIC OLED , 128x64	https://www.amazon. de/qp/product/B01IROOJ48/ref=ppx yo dt b asin tit le o00 s00?ie=UTF8&psc=1
38	SiPM	1	€79.75	€79.75	1	6x6mm SiPM MicroFC-60035- SMT	Mouser part Number: 863-MFC600355MTTR1 (https: //www.mouser.com/ProductDetail/ON- Semiconductor/MICROFC-60035-SMT-TR1? qs=byeeYqUIh0MxSRIaBcfS6g%3D%3D)
39	Plastic scintillator	1	€43.11	€43.11	1	5x5x1 cm Plastic scintillator	https://www.ebay.com/itm/Bicron-BC408-Plastic- Scintillator-5x5x1-cm-for-CosmicWatch-Muon- Detector-Project/263355405917? epid=2044114641&hash=item3d5134965d:q: XxsAAOSwSWScWxPb
40	Main PCB + SiPM PCB	1	€0.49	€4.90	10	2 layer, 10cm x 10cm, 1.6mm thickness	https://www.elecrow.com/pcb-manufacturing. html
41	Aluminum Case	1	€8.99	€17.98	2	Aluminium case	http://www.enclosuresandcasesinc.com/
42	Front and back plate	1	€0.91	€9.05	10	10cm x 15cm x 2.5mm acrylic end plates.	https://www.elecrow.com/acrylic-cutting.html
43	5mm LED holder	1	€0.15	€0.15	1	LED Light Mounting Holders	https://grobotronics.com/led-holder-5mm-chrome- finish.html
44	Tin Foil or aluminum foil	1	€0.00	€0.00		10x10cm αλουμινόχαρτο	
45	Optical Gel	<1ml	€0.00	€0.00		Χρησιμοποιήσαμε βαζελίνη	
46	Black electrical tap	~1m	€0.00	€0.00		Μαύρη ηλεκτρική ταινία για το τύλιγμα του σπινθηριστή	Για αυτά τα υλικά δεν υπήρξε κόστος καθώς υπήρχαν
47	microSD Card	1	€0.00	€0.00		Οτιδήποτε > 200 Mb.	ηση είτε στο εργαστηρίο και σε προσωπικό αποσεμα
48	Coincidence Cable	1	€0.00	€0.00			
49	BNC Cable	1	€0.00	€0.00			
Μεταφορικά & Φόροι & Τελωνεία		elecrow		€87.96			
		mouser		€19.63	total = €521.99		
		ebay		€39.51			
		digikey		€31.32			
		RS		€33.47			
		enclosures and cases		€27.11			

Πίνακας 1 - Λίστα Υλικών για τη κατασκευή του οργάνου

Στον παραπάνω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αγοράστηκαν καθώς και το κόστος όλου του έργου.

Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στα 521.99 EUR.

Για την πλήρη λίστα με λειτουργικούς συνδέσμους μπορείτε να τη βρείτε εδώ: <u>https://drive.google.com/file/d/1A4hhe_tBol119lmXb84q9UClT_K0WOen/view?usp</u> <u>=sharing</u>

Στοιχείο	Τιμή	Περιγραφή
		κεντρική πλακέτα
R1	10k	RES SMD 10K OHM 1% 1/8W 0805
R2	226k	RES SMD 226K OHM 1% 1/8W 0805
R3	249	RES SMD 249 OHM 1% 1/4W 0805
R4	1k	RES SMD 1K OHM 1% 1/8W 0805
R5	10k	RES SMD 10K OHM 1% 1/8W 0805
R6	100k	RES SMD 100K OHM 1% 1/8W 0805
R7	100k	RES SMD 100K OHM 1% 1/8W 0805
R8	1k	RES SMD 1K OHM 1% 1/8W 0805
R9	Short	RES SMD 0 OHM JUMPER 1/8W 0805
R10	NS	
R14	NS	
R15	1k	RES SMD 1K OHM 1% 1/8W 0805
R16	10k	RES SMD 10K OHM 1% 1/8W 0805
R17	Short	RES SMD 0 OHM JUMPER 1/8W 0805
R18	NS	
R19	NS	
R20	10k	RES SMD 10K OHM 1% 1/8W 0805
R24	24.9k	RES SMD 24.9K OHM 1% 1/8W 0805
D1	500ma diode	DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOD123
D2	500ma diode	DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOD123
L1	47uH	FIXED IND 47UH 170MA 1.3 OHM SMD
L2	2.5k Ferrite Bead	FERRITE BEAD 2.5 KOHM 0805 1LN
C1	22pF	CAP CER 22PF 50V NP0 0805
C2	0.47uF	CAP CER 0.47UF 50V X7R 0805
С3	1uF	CAP CER 1UF 50V Y5V 0805
C4	10uF	CAP CER 10UF 6.3V X5R 0805
C5	0.1uF	CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805
C6	20nF	CAP CER 20nF 50V X7R 0805
C7	10.0pF	CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0805
C14	Short	RES SMD 0 OHM JUMPER 1/8W 0805
C15	0.1uF	CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805
C18	1uF	CAP CER 1UF 50V Y5V 0805
U1	LT3461	3MHz Step-Up DC/DC Converters
U2	LT1807IS8#PBF	325MHz, Dual, Rail-to-Rail Input and Output, Precision Op Amps
U7	NS	
Reset	Reset button	SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V
2x4 SD header	2x3 header +2x1	header for mounting SD card PCB. 2x3 + 1x2
15x1 header	15x1 header	2x headers for mounting Arduino, should come with Arduino
Arduino_Nano	Arduino Nano	16 MHz CH340/ATmega328P Arduino Nano
BNC receptacle	BNC header	CONN BNC JACK R/A 50 OHM PCB

OLED header	4 pin header	CONN FEMALE 4POS .100" R/A TIN					
LED	LED light	Any color, 5mm					
6-pin Header	6-pin Header	SOCKET 7 MM SOLDER TAIL DOUBLE					
3.5 mm jack	3.5mm jack	CONN JACK 4COND 3.5MM SMD R/A					
Temp	ТМР36	Temperature Sensors TMP36 Precision Linear Analog Output					
κάρτα microSD							
U6	3.3V regulator	IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT23-3					
U8	SD card socket	SMT SMD Cell Phone TF Micro SD Memory Card Slot Holder Sockets					
U10	Non-Inverting Buffer	High Speed CMOS Logic Hex Non-Inverting Buffers					
C16	10uF	CAP CER 10UF 6.3V X5R 0805					
C17	0.1uF	CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805					
R25	NS						
		SiPM					
SiPM1	SIPM	SiPM MicroFC-60035-SMT					
C8	10 nF	CAP CER 10000PF 50V X7R 0805					
С9	10 nF	CAP CER 10000PF 50V X7R 0806					
C10	10 nF	CAP CER 10000PF 50V X7R 0807					
C11	10 nF	CAP CER 10000PF 50V X7R 0808					
R11	49.9	RES SMD 49.9 OHM 1% 1/8W 0805					
R12	49.9	RES SMD 49.9 OHM 1% 1/8W 0805					
R13	49.9	RES SMD 49.9 OHM 1% 1/8W 0805					
SiPM PCB 6-Pin	6-pin Pins	WM17457-ND					

Πίνακας 2 - Πίνακας αναφοράς στοιχείων και πλακέτας
Date	count / index	computer_time	Arduino time	Arduino Amplitude	Amplitude	Dead time
2022-02-25	26	22:02:04	18799	22.23	103	125
2022-02-25	27	22:02:05	18839	38.29	224	130
2022-02-25	28	22:02:05	19008	20.96	88	135
2022-02-25	29	22:02:05	19380	22.94	112	140
2022-02-25	30	22:02:05	19469	30.55	179	145
2022-02-25	31	22:02:05	19576	21.67	96	150
2022-02-25	32	22:02:06	19823	38.48	225	155
2022-02-25	33	22:02:06	19869	46.26	268	160
2022-02-25	34	22:02:06	19991	44.69	259	165
2022-02-25	35	22:02:06	20083	23.58	120	170
2022-02-25	36	22:02:07	20888	27.28	156	175
2022-02-25	37	22:02:08	22345	30.09	176	180
2022-02-25	38	22:02:09	23272	50.47	289	185
2022-02-25	39	22:02:09	23439	64.67	344	190
2022-02-25	40	22:02:09	23652	28.2	163	195
2022-02-25	41	22:02:10	23917	143.61	504	200
2022-02-25	42	22:02:10	24049	64.67	344	205
2022-02-25	43	22:02:10	24082	40.44	236	210
2022-02-25	44	22:02:10	24161	22.63	108	215
2022-02-25	45	22:02:10	24435	125.87	472	220
2022-02-25	46	22:02:11	25624	64.67	344	225
2022-02-25	47	22:02:12	26311	45.37	263	230
2022-02-25	48	22:02:12	26567	45.24	262	235
2022-02-25	49	22:02:15	28915	47.25	273	240
2022-02-25	50	22:02:15	29051	20.96	88	245

Πίνακας 3 - Δείγμα δεδομένων όπως καταγράφηκαν από το σύστημα καταγραφής πραγματικού χρόνου της ιστοσελίδας <u>http://cosmicwatch.lns.mit.edu/measure</u> πλήρες dataset: [40]

###	Device ID: Ser_MKII	home	~60mins	26/02/22	
Event	Ardn_time[ms]	ADC[0-1023]	SiPM[mV]	Deadtime[ms]	Temp[C]
1	1521	79	20.03	0	19.61
2	2715	103	22.23	13	19.61
3	3819	105	22.39	29	19.61
4	4141	216	36.85	45	19.61
5	4174	103	22.23	61	19.61
6	4912	463	119.23	77	19.61
7	6953	143	25.74	96	19.61
8	7581	199	33.86	112	19.61
9	9161	415	95	128	19.61
10	9680	233	39.92	144	19.61
11	14466	423	97.36	161	19.61
12	16168	511	149.39	178	19.61
13	17510	444	109.09	195	19.61
14	17991	659	253.36	212	19.61
15	18110	118	23.42	229	19.61
16	19139	135	24.92	246	19.61
17	19839	156	27.28	263	19.61
18	21982	92	21.32	280	19.61
19	22402	384	80.08	297	19.61
20	23452	96	21.67	314	19.61
21	23583	224	38.29	331	19.61
22	23613	204	34.73	352	19.61
23	23903	353	67.64	369	19.61
24	24221	364	71.71	388	19.61
25	25698	705	364.03	405	19.61
26	26575	140	25.42	422	19.61
27	27504	460	119.54	439	19.61

Πίνακας 4 - Δείγμα δεδομένων πρώτης μέτρησης 6.1.1 πλήρες data set: [41]

###	Device ID: Ser_MKII		metro monastiraki	26/02/2022	-32 meters ug
Event	Ardn_time[ms]	ADC[0-1023]	SiPM[mV]	Deadtime[ms]	Temp[C]
1	369	108	22.63	0	16.71
2	1154	366	72.41	13	16.71
3	1991	161	27.93	29	16.71
4	2679	115	23.18	45	16.71
5	3430	275	47.73	61	16.71
6	4349	120	23.58	77	16.71
7	5121	214	36.49	96	16.71
8	5710	152	26.78	112	16.71
9	6435	220	37.58	132	16.71
10	6488	103	22.23	148	16.71
11	8090	259	44.69	164	16.71
12	8710	112	22.94	181	16.71
13	9264	428	101.58	197	16.71
14	9501	271	46.93	213	16.71
15	9628	271	46.93	230	16.71
16	10650	583	201.26	247	16.71
17	10974	462	120.87	264	16.71
18	12869	273	47.25	281	16.71
19	12920	368	72.93	298	16.71
20	14000	121	23.66	315	16.71
21	14534	361	70.62	332	16.71
22	14588	275	47.73	348	16.71
23	15067	327	59.28	365	16.71
24	18097	108	22.63	384	16.71
25	18855	131	24.54	401	16.71
26	18987	192	32.67	418	16.71
27	19144	92	21.32	434	16.71

101

Πίνακας 5 - Δείγμα δεδομένων από τον υπόγειο σταθμό μετρό του Μοναστηρακίου στις 26/02/2022 Το βάθος ήταν 32 μέτρα κάτω από τη Γη και οι μετρήσεις διήρκησαν 58 λεπτά και καταγράφτηκαν συνολικά 4099 γεγονότα. Το πλήρες data set μπορεί να προβληθεί εδώ: <u>https://drive.google.com/file/d/1Lf-Fwu-JN5PmNyaOAyFj73_CYwTvs4Yl/view?usp=sharing</u>

###	Device ID: Ser_MKII		monastiraki	26/02/2022	height = 80m
Event	Ardn_time[ms]	ADC[0-1023]	SiPM[mV]	Deadtime[ms]	Temp[C]
1	879	743	466.23	0	19.61
2	2488	207	35.26	12	19.61
3	2929	280	48.67	28	19.61
4	3254	319	57.64	44	19.61
5	3758	358	69.1	60	19.61
6	4338	159	27.66	76	19.61
7	4491	120	23.58	95	19.61
8	4609	83	20.46	111	19.61
9	5392	300	52.79	127	19.61
10	5927	408	90.57	143	19.61
11	7019	536	160.18	159	19.61
12	8886	583	201.26	180	19.61
13	9357	147	26.19	196	19.61
14	9897	384	80.08	212	19.61
15	10802	531	160.62	228	19.61
16	11012	444	109.09	245	19.61
17	12829	127	24.18	261	19.61
18	15961	591	188.65	278	19.61
19	16134	432	101.61	295	19.61
20	16648	230	39.39	312	19.61
21	17823	124	23.92	329	19.61
22	17921	568	189.84	346	19.61
23	17988	126	24.09	363	19.61
24	18105	280	48.67	382	19.61
25	18979	199	33.86	399	19.61

Πίνακας 6 - Δείγμα δεδομένων από τη περιοχή του Μοναστηρακίου στις 26/02/2022 στην επιφάνεια, δηλαδή +32 μέτρα από τις μετρήσεις του Πίνακα 5. Οι μετρήσεις διήρκησαν 58 λεπτά και καταγράφτηκαν συνολικά 3724 γεγονότα. Το πλήρες data set μπορεί να προβληθεί εδώ: <u>https://drive.google.com/file/d/1_SL9eyU0rM6yz9oYWOUuI7wd-l1XT8YU/view?usp=sharing</u> Παράρτημα



Σχέδιο 1 CAD για τη δημιουργία εσοχών στον σπινθηριστή [39]



Σχέδιο 2 CAD για τις ιδανικές διαστάσεις του κουτιού. Προσοχή! Διαστάσεις είναι σε ίντσες [39]



Σχέδιο 3 Κυκλωματικό διάγραμμα της διάταξης Οι επιμέρους πλακέτες (Κεντρική, SiPM, microSD) χωρίζονται με το μπλε παχύ περίγραμμα και την αντίστοιχη ένδειξη [37]

Ευρετήριο Σχημάτων & Πινάκων

Κεφάλαιο	2 - Θεως	ρητικό Υπόβαθοο	4
Σγ	χήμα 2.1	The Cosmic Microwave Background as seen from t	5
Σγ	χήμα 2.2	Καταιγισμός σωματιδίων και τα παφάγωγά τους (Davies, 2022) [6]	7
Σγ	χήμα 2.3	Αναπαφάσταση του Μαγνητικού Πεδίου της Γης	9
Σγ	χήμα 2.4	Christopher C. Finlay, Clemens Kloss, Nils Olsen, [13]	10
Κεφάλαιο	3 - State	of the art	16
Σγ	χήμα 3.1 .	Διάγραμμα απαριθμητή Geiger. Η διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού	17
Σγ	χήμα 3.2	Μήκος κύματος συναφτήσει της μέγιστης εκπομπής	19
П	ίνακας 3.	1 BC-408 Datasheet, n.d. [16]	19
Σγ	χήμα 3.3	Τοοχιές σωματιδίων μέσα σε θάλαμο Νέφους (Fraser, 2002) [17]	21
Σγ	χήμα 3.4	Ένας τυπικός Φωτοπολλαπλασιαστής σε σωλήνα [21]	22
Σγ	χήμα 3 . 5	Ανιχνευτές Avalanche Photodiodes (APD) [21]	23
Σγ	χήμα 3.6	Απορροφητικότητα φωτονίων στο πυρίτιο [21]	25
Σγ	χήμα 3.7	(α) Σχήμα του Geiger Mode. Σχήμα (β) "Ψηφιακός" παλμός εξόδου	27
Σγ	χήμα 3.8	Διάταξη μικοοκυψελών με τη τελική έξοδο του σήματος	28
Κεφάλαιο	4 - Κατα	ασκευή οργάνου	40
Σγ	χήμα 4.1	Οι ακουλικές επιφάνειες όπως παρελήφθησαν	43
Σγ	χήμα 4.2	Δείγμα του αλουμινένιου κουτιού που χρησιμοποιήθηκε	44
Σγ	χήμα 4.3	Οθόνη OLED που χοησιμοποιήθηκε με το VCC να είναι στη 4η θέση (κάτω)	44
Σγ	χήμα 4.4	Οι πλακέτες όπως παφελήφθησαν από το κατάστημα παφαγωγής PCB	47
Σγ	χήμα 4.5	Η κάτω όψη της κεντρικής πλακέτας	49
Σγ	χήμα 4.6	Κάτω όψη της πλακέτας του SiPM	51
Σγ	χήμα 4.7	Στην (α) διακρίνεται η κάτω όψη της πλακέτας του microSD	52
Σγ	χήμα 4.8	Δημιουργία εσοχών	53
Σγ	χήμα 4.9	Πιστόλι Θερμού Αέρα	54
Σγ	χήμα 4.10	Ο σπινθηριστής τυλιγμένος με αλουμινόχαρτο και μαύρη μονωτική ταινία	54
Σγ	χήμα 4.11	Η τελική μορφή του σπινθηριστή αφού έχει τυλιχτεί με	55
Σγ	χήμα 4.12	. Κοντινή όψη του 6 pin connector	56

Σχήμα 4.13 Πφώτο δείγμα λειτουργίας με πολύ υψηλό Count Rate	57
Σχήμα 4.14 Εμπρόσθια και οπίσθια όψη του οργάνου (από αριστερά προς τα δεξιά)	58
Σχήμα 4.15 Εμπρόσθια όψη με κουμπωμένο το καπάκι και σε λειτουργία	58
Κεφάλαιο 5 - Ηλεκτοονική Λειτουογία	59
Σχήμα 5.1 Κυκλωματικό διάγραμμα του DC-DC Booster	61
Σχήμα 5.2 Διάταξη κυκλώματος SiPM	62
Σχήμα 5.3 Κάτοψη του αισθητήρα SiPM [19]	63
Σχήμα 5.4 Διάταξη κυκλώματος Ενίσχυσης	64
Σχήμα 5.5 Διάταξη κυκλώματος Ενίσχυσης	66
Σχήμα 5.6 Δεδομένα εξόδου που ποοβάλλει η οθόνη OLED	68
Σχήμα 5.7 Σχέση συσχετισμού μετοημένου παλμού με τιμή ADC	69
Σχήμα 5.8 Δείγμα δεδομένων που λήφθηκαν από το Serial Monitor	70
Σχήμα 5.9: Ένα δείγμα της μοφφής των καταγεγφαμμένων	72
Σχήμα 5.10 Μέγεθος ολοκληφωμένου (LT3461A) [44]	74
Κεφάλαιο 6 - Μετρήσεις & Συμπεράσματα	75
Διάγφαμμα 6.1 Ιστόγφαμμα μετφήσεων συναφτήσει των τιμών ADC	76
Διάγοαμμα 6.2 Ιστόγοαμμα τιμών που καταχωρήθηκαν από τον	77
Διάγφαμμα 6.3 Count Rate που υπολογίστηκε σε 59 λεπτά λειτουφγίας του οφγάνου	78
Διάγραμμα 6.4 Ζωντανή αναπαράσταση ιστογράμματος	79
Διάγφαμμα 6.5 (α) Πλήθος γεγονότων/σημάτων ανά χφόνο δειγματοληψίας.	80
Παράρτημα	94
Πίνακας 1 - Λίστα Υλικών για τη κατασκευή του οργάνου	96
Πίνακας 2 - Πίνακας αναφοράς στοιχείων και πλακέτας	98
Πίνακας 3 - Δείγμα δεδομένων όπως καταγράφηκαν από το σύστημα	99
Πίνακας 4 - Δείγμα δεδομένων πρώτης μέτρησης 6.1.1 πλήρες data set: [41]	100
Πίνακας 5 - Δείγμα δεδομένων από τον υπόγειο σταθμό μετοό του Μοναστηρακίου	101
Πίνακας 6 - Δείγμα δεδομένων από τη περιοχή του Μοναστηρακίου	102
Σχέδιο 1 CAD για τη δημιουργία εσοχών στον σπινθηριστή [39]	103
Σχέδιο 2 CAD για τις ιδανικές διαστάσεις του κουτιού	.104
Σχέδιο 3 Κυκλωματικό διάγραμμα της διάταξης	105